修士学位論文

TGC(Thin Gap Chamber)の中性子に対する放射線耐性の研究

神戸大学自然科学研究科物理学専攻 喜家村 裕宣

平成 18 年 2月 10 日

abstract

スイスのジュネーブにある CERN(欧州原子核研究機構)で、2007年より稼動開始予定の大型陽子陽子衝突型 加速器 (LHC=Large Hadron Collider)の建設が進められている。LHC は重心系で世界最高のエネルギーである 14*TeV* を誇る陽子陽子衝突型加速器であり、前人未踏のエネルギー領域が実現されるため、特に新粒子の発見に は大きな期待が寄せられている。他にもトップクオークの物理やB中間子における CP 非保存についての研究な ど様々な研究が行われる。

LHC に設置される検出器のひとつに ATLAS 検出器がある。ATLAS 検出器を用いた ATLAS 実験では主に、未 発見粒子である Higgs 粒子や SUSY 粒子の探索が行われる。ATLAS 検出器のエンドキャップ部分にミューオン のトリガー検出器として設置される TGC(Thin Gap Chamber) は KEK(高エネルギー加速器研究機構)で生産さ れ、神戸大学において動作検査が行われた。すでに全数が CERN に送られ、ATLAS 検出器へのインストールも 始まっている。

ATLAS 実験が始まるとTGC は高頻度の 、中性子バックグラウンド環境下に置かれることになる。中でも数 $MeV \sim +$ 数MeV の中性子の相互作用により放出される陽子、原子核はTGC のガスボリューム内に大きなエネ ルギーを落とし、MIP(Minimum Ionization Particle)に比べて非常に大きな信号を生成し、TGC の安定動作に 悪影響を及ぼす恐れがある。中性子に対するTGC の動作特性の研究は過去にも行われているが、未だ不明な点 が多い。よって、ATLAS 実験でのTGC に対する中性子の影響を把握するため、TGC の中性子に対する動作特 性の研究を行った。中性子源は日本原子力研究所 FNS(Fusion Neutronics Source)を用い、TGC に 2.5MeV 及 U14MeV の単色中性子を照射して、TGC の中性子感度、出力電荷量、放電レート、クロストークイベントにつ いての研究を行った。同時に、中性子に対する影響を軽減するような代替ガスの研究として、 CO_2 ベースのガス に加え、 CF_4 ベースのガスを使用して、その中性子に対する耐性の研究も行った。得られた結果から、中性子に よる信号の特性、TGC の中性子に対する耐性、 CF_4 ベースのガスを使用した際の TGC の動作などについての 見解が得られた。また、中性子照射試験の結果に対する評価、理解を得るためにGeant4を用いた TGC への中 性子照射シミュレーションを行った。シミュレーションで取得したデータにより試験の内部構造を知ることが出 来、理解を深めることが出来た。

contents

1		Introduction	1
2		LHC 計画	4
3		ATLAS 実験	6
	3.1	ATLAS 実験で期待される物理	6
		3.1.1 標準模型における Higgs	6
		3.1.1.1 Higgs 粒子の生成	6
		3.1.1.2 Higgs 粒子の崩壊	6
		3.1.1.3 ATLAS の Higgs 粒子発見能力	7
		3.1.2 超対称性粒子 (SUSY) ····································	10
		3.1.3 超対称性 Higgs 粒子	10
		3.1.4 その他の物理	11
	3.2	ATLAS 検出器	12
		3.2.1 内部飛跡検出器	13
		3.2.2 カロリメーター	14
		3.2.3 超伝導空芯トロイドマグネット	15
		3.2.4 ミューオン検出器	16
		3.2.4.1 MDT (Monitored Drift Tube)	17
		3.2.4.2 CSC(Cathode Strip Chamber)	18
		3.2.4.3 RPC(Resistive Plate Chamber)	19
		3.2.4.4 TGC(Thin Gap Chamber)	20
	3.3	ミューオントリガーシステム	21
		3.3.1 レベル1エンドキャップミューオントリガー	21
4		Thin Gap Chamber (TGC)	24
	4.1	動作原理....................................	24
		4.1.1 ガス増幅と動作モード	24
		4.1.2 充填ガス	25
	4.2	TGC の構造	27
		4.2.1 ASD(Amplifier Shaper Discriminator) Board	29
	4.3	中性子の信号による TGC への影響	31
		4.3.1 中性子の性質	31
		4.3.1.1 中性子の発生	31
		4.3.1.2 中性子と物質の相互作用	31
		4.3.2 中性子の TGC に対する影響	31
5		中性子照射試験	33
	5.1	中性子源....................................	33
	5.2	T7 タイプ TGC と小型 TGC	35
	5.3	実験セットアップ...................................	36

	5.3.1 5	データ取	得セットフ	マップ .				 	 	 		 				 37
	5	0.3.1.1	ADC を用	いたデ	ータ耳	又得 .		 	 	 						 37
	5	0.3.1.2	TMC を月	肌たデ	ータ耳	又得 .		 	 • •	 		 •••				 38
	5	.3.1.3	カレント	モニター				 	 	 		 •••				 39
	5	.3.1.4	ガス供給	システム	م			 	 	 		 				 40
5.4	実験結果	と考察						 	 	 		 				 41
	5.4.1 9	中性子感	度					 	 	 		 •••				 41
	5.4.2	出力電荷	量					 	 	 		 •••				 42
	5.4.3 方	放電レー	F					 	 	 		 •••				 47
	5.4.4	クロスト	ーク・・					 	 	 		 		• •		 48
5.5	TGC 中国	性子シミ	ュレーシ	ョン				 	 	 		 •••				 52
	5.5.1 S	シミュレ	ーションの	D概要と	セット	トアッ	プ	 	 	 		 •••				 52
	5.5.2 S	シミュレ	ーション約	ま果と考	察			 	 •••	 	• •	 •••	• •	• •		 54
	まとめと	:今後														58
6.1	まとめ.							 	 	 		 			 	 58
6.2	今後の予	定						 	 	 		 			 	 60

6

1 Introduction

現在、スイスのジュネーブにある欧州原子核研究機構 (CERN) において、重心系で世界最高エネルギーである 14*TeV* を誇る大型陽子陽子衝突型加速器 (LHC) が、2007年の稼動開始に向けて建設中である。LHC により、これまで踏み入れることの出来なかった TeV 領域に及ぶエネルギー領域が実現され、新しい物理現象の研究が行われる。Higgs 粒子、SUSY 粒子と言った新粒子の発見や、top クオークの物理、B 中間子での CP 非保存の研究な どが目的とされている [1]。LHC に設置される検出器の中のひとつである ATLAS 検出器では、主に Higgs 粒子、SUSY 粒子の探索が行われる。Higgs 粒子や SUSY 粒子は直接観測することは出来ず、崩壊の終状態を適確に捉 えることが重要になる。しかし、内部構造を持つ陽子同士が重心系で 14*TeV* のエネルギーで衝突するため、非常に多くの反応過程が許され、非常に大きなバックグラウンドの中から必要な信号を抜き出さなければならない。こういった理由から、Higgs 粒子や SUSY 粒子の崩壊の終状態に現れる粒子の中でも観測、特定が比較的容易で ある μ 粒子は、Higgs 粒子、SUSY 粒子の発生の証拠を特定するのに必要不可欠である。日本ではこの μ 粒子に 注目し、 μ 粒子のトリガーチェンバーである TGC の生産、検査、TGC からの信号読出しのエレクトロニクスの 開発を行ってきた [2]。現在は、拠点はすでに CERN に移り、ATLAS 検出器へのインストールが行われている。

ATLAS 実験が始まると TGC は、高頻度の γ 、中性子バックグラウンド環境下に置かれることになる。TGC 設置位置での γ 、中性子バックグラウンドのレートが、FULKA2000を用いたシミュレーションにより見積もられている [3]。(Fig.1.1、Fig.1.2) こういった環境下で TGC は安定に動作しなければならない。従って、前もってその動作の確認、動作特性の把握を行っておかなければならない。高頻度 γ 線に対しての動作テストはすでに行われ、ATLAS 実験で予想される数 kHz の γ 線バックグラウンド環境下で安定して動作することが確認されている [4]。

TGCの中性子感度についてはすでに測定が行われ、2.5*MeV*の中性子に対しておよそ 0.048 %、14*MeV*の中 性子に対しておよそ 0.13 %という結果が得られており [5]、ATLAS 実験では TGC への中性子ヒットレートは数 *Hz/cm²* 以下であると見積もられている。しかしこれは、比較的弱い中性子源を用いての測定であり、統計量が 少なく、実際の高頻度中性子バックグラウンド環境での動作については不明な点を残す。また、中性子による信 号は、MIP(Minimun Ionization Particle)に比べ非常に大きく、放電の頻発やそれによる TGC の早期劣化、大 きな信号によりヒットのないチャンネルからも信号が出てしまうクロストーク、それが多チャンネルにわたるマ ルチヒットなど、TGC の動作に悪影響を及ぼす恐れがある。したがって、ATLAS 環境下に匹敵する高頻度中性 子に対する TGC の動作特性を把握しておくことは非常に重要である。

中性子の、TGC の動作への影響の研究には、日本原子力研究所 FNS の大強度単色中性子源を利用し、2.5 MeV、 14MeV の単色中性子による TGC への中性子照射試験を行った。試験には ATLAS 検出器として実際に使用され る TGC で、T7 と呼ばれるタイプの TGC と、小型の TGC を使用し、それらの中性子に対する動作特性の研究 を行った。同時に、本番で TGC の動作ガスとして使用される CO_2 +n-Pentane に加え、検出器劣化現象の抑制 に実績のある CF_4 [6] を混入した CF_4 +n-Pentane も使用し、放射線耐性のある代替ガスの研究も行った。取得 したデータは

- 1. 中性子感度
- 2. 中性子入射時の出力電荷量
- 3. 中性子入射時の放電レート
- 4. クロストークイベント発生レート

である。また、Geant4をもとにしたシミュレーションを行い、この実験を評価するとともに、実験結果への理解 も深められた。



Fig. 1.1: ATLAS 実験ホールの γ 線バックグラウンド Flux のシミュレーション (High Luminosity) [1]



Fig. 1.2: ATLAS 実験ホールの中性子線バックグラウンド Flux のシミュレーション (High Luminosity) [1]

本論文では、2 章では LHC 計画について、3 章では ATLAS 実験について、4 章では TGC について、5 章で は中性子照射試験について、6 章ではまとめと今後の予定を述べる。

2 LHC計画

スイスにある欧州原子核研究機構(CERN)において、大型陽子陽子衝突型加速器LHC(Large Hadron Collider) が、2007年に稼働開始を予定している。LHC加速器は、重心系のエネルギーにして14*TeV*の世界最高エネル ギーを持つ円形加速器である。2000年に停止した大型電子陽電子衝突型加速器LEP(Large Electron Positron Collider)のトンネル内(周長約27km)に現在建設が進められている(Fig.2.1)。LHC加速器の主要なパラメータ をTable2.1に示す。LHC計画の目的は、標準模型(Standard Model)の基本粒子であるHiggs粒子の探索や、超 対称性粒子の探索、トップクオークの物理、B中間子でのCP非保存の研究等である。LHC加速器は、最大の特 徴である14TeVの重心エネルギーと10³⁴ cm⁻² s⁻¹の高ルミノシティによって、TeV領域の物理の開拓を可能 にしている。陽子陽子衝突型加速器は、電子に比べ陽子の質量が重いため、円形加速器におけるシンクロトロン 放射光の損失が小さく、高エネルギーを得るのに適している。反面、陽子は内部構造を持つため、複合粒子同士 の非弾性散乱により生成されるジェット等のバックグラウンドが非常に多く、その中から興味のある事象を選別 することは困難を伴う。このため、LHCに設置される検出器は、入射粒子数が高頻度な環境に耐え、研究目的の 物理事象の選別を可能とするものであることが要請される。



Fig. 2.1: LHC 加速器 [7]

LHC 加速器には4つの衝突点があり、それぞれ以下の検出器が設置される。

- 1. ATLAS (A Troidal LHC ApparatuS)
- 2. CMS (The Compact Muon Solenoid)(Fig.2.2)
- 3. ALICE (A Large Ion Collider Experiment)(Fig.2.3)
- 4. LHC-B(Fig.2.4)

ATLAS 検出器、CMS 検出器は汎用検出器であり、LHC-B は B 中間子の研究に特化したもの、ALICE は重イオン衝突実験を目的とした検出器である。

主リング周長	26,658.87m	バンチ間隔	24.95 nsec
入射エネルギー	450 GeV	バンチ内陽子数	1.1 × 10 ¹¹ 個
陽子エネルギー	7.0 TeV	バンチ長さ (陽子)	77mm
High Luminosity(7年)	$10^{34} \ cm^{-2}s^{-1}$	衝突点でのビーム半径	$15.9~\mu m$
Low Luminosity(3年)	$10^{33} \ cm^{-2}s^{-1}$	ビーム衝突角度	$300 \ \mu rad$
Luminosity Lifetime	10 時間		

Table 2.1: LHC 加速器主要パラメータ [8]



Fig. 2.2: CMS[9]



Fig. 2.3: Alice[9]



Fig. 2.4: LHC-B[9]

3 ATLAS 実験

ATLAS 検出器は汎用検出器であり、ATLAS 実験の目的は、標準模型の基本粒子であり、唯一未発見の粒子で ある Higgs 粒子の探索及び超対称性 (SUSY) 粒子の探索、top クオークの物理、B 中間子での CP 非保存の研究 等と多岐に渡っている。LHC が世界最大の高エネルギーを誇る陽子陽子衝突型加速器であることから、中でも特 に未発見粒子の探索に大きな期待が寄せられている。

3.1 ATLAS 実験で期待される物理

3.1.1 標準模型における Higgs

電弱相互作用での自発的対称性の破れの機構を説明するためにその存在が必要とされる Higgs 粒子は、質量起源を解明する手がかりと期待されるため、その発見は非常に重要な意味がある。Higgs 粒子自身の質量については、理論的におよそ 1TeV 以下とされている。下限については、これまでに行われた実験により 100GeV 以上とされている。ATLAS 実験では、100GeV 以上 1TeV 以下の全ての質量領域で、標準模型における Higgs 粒子の探索が可能である。

3.1.1.1 Higgs 粒子の生成

Higgs 粒子は質量の重い粒子と結合するため top クオークや W 粒子、Z 粒子のような質量の非常に重い粒子と 強く相互作用し、その生成過程としては Fig.3.1 が主となると考えられている。Fig.3.2 に Higgs 粒子の生成断面 積を示す。これより $m_{Higgs} = 200 GeV$ としたとき、 $10^{34} cm^{-2} s^{-1}$ の高ルミノシティモードで1 年間運転すると 約 20 万イベント生成されると予想出来る。

3.1.1.2 Higgs 粒子の崩壊

Higgs 粒子の崩壊モードは、その質量により異なる。Fig.3.3 に各崩壊モードの質量に対する分岐比をプロット したものを示す。それぞれの崩壊モードでバックグラウンドから分離できる Higgs の質量領域は、次の 4 タイプ である。

(1) $100GeV < m_H < 120GeV$

$$H \to \gamma\gamma$$
 (3.1)

この領域での Higgs 粒子の主な崩壊過程は、 $b\bar{b}$ 、 $c\bar{c}$ 、 $\tau^+\tau^-$ であるが、これらについては陽子・陽子素過程による大きなバックグラウンドが大きく測定が難しい。それゆえ、分岐比が 10^{-3} と小さいが、 $\gamma\gamma$ への崩壊過程を用いる。この測定にはエネルギー、角度分解能の優れた電磁カロリメータが要求される。

(2) $130 GeV < m_H < 2m_Z$

$$H \to ZZ^* \to l^+ l^- l^+ l^- \tag{3.2}$$

この質量領域に入ると、 W^{\pm} 、Zの質量を超えるため、 WW^* 、 ZZ^* の崩壊モードが始まる。この時のバッ クグランドとして、 $pp \rightarrow ZZ^*/Z\gamma^*$ 、 $Zb\bar{b} \rightarrow 4lepton$ などがあるが、1 組の l^+l^- 対の横運動量 (p_T) に対し て制限をつけ、さらにもう1 組の l^+l^- 対の不変質量に対し制約を付ける事により、これらのバックグラウ ンドを除去することが出来る。

$$H \to ZZ \to l^+ l^- l^+ l^- \tag{3.3}$$

この崩壊モードは"Gold Plated Channel"と呼ばれ、分岐比も大きく Z-mass constraint (2 組の *lepton* 対の不 変質量 $m_{l\bar{l}} \sim m_Z$) によるイベントの取捨選択が有効であるため、最も信頼性の高いモードであり、比較的き れいな信号が得られる。 $m_H = 200 GeV$ としたとき、高ルミノシティで 1 年間運転して $(100 fb^{-1})100$ events 程度が期待されている。

 $(4) \quad 700 GeV < m_H < 1 TeV$

$$H \to ZZ \to l^+ l^- \nu \nu, \ H \to WW \to l \nu j j$$

$$(3.4)$$

この領域になると、より分岐比の高い (*4lepton* モードの約150倍) これらのモードを用い統計量を稼ぐ事 が必要となる。これらのイベントは、前方にクォークによる2つのジェットが生じるのが特徴であり、これ をタグする事により同定が可能である。

3.1.1.3 ATLAS の Higgs 粒子発見能力

LHC を高ルミノシティ - で約1年運転したとき、ATLAS 検出器において Higgs 粒子が発見される能力を Fig.3.4 に示す。このグラフの縦軸は Higgs を発見する能力を現し、予想される Higgs のイベント数をバックグラウンド のイベント数の平方根で割ったものである。縦軸の値が高い程、Higgs のイベントがあったときに、それがバッ クグラウンドでは説明できないことを示し、 $100 fb^{-1}$ あれば ATLAS 実験において Higgs 粒子を 10σ 以上の確か さで発見できる事を示している。また、ATLAS 検出器は、Higgs 粒子の質量の上限値である 1 TeV まで探索出来 ることを示しており、非常に優れた検出器である事を示している。





Fig. 3.1: Higgs 生成の代表的な生成過程: (a)gluon-gluon 融合 (gluon fusion)、 (b)WW/ZZ 融合 (Vector Boson Fusion)、 (c)ttH 生成過程 (ttH production)、 (d)W/Z 粒子随伴生成 (W/Z associate production)



Fig. 3.2: Higgs 粒子の生成断面積



Fig. 3.3: Higgs 粒子の分岐比と質量の関係



Fig. 3.4: ATLAS の Higgs 発見能力 [10]

3.1.2 超対称性粒子 (SUSY)

素粒子物理学の究極の目標は重力を含めた力の大統一であり、超対称性 (SUSY) の発見はこれに向けての大いなる一歩であると最も有力視されている。LEP でのゲージ理論の精密検証の結果、超対称性による力の大統一の可能性が示された。

この超対称性は、ボソンとフェルミオンを交換する。つまり通常知られているボソンやフェルミオンに対し、 スピンが 1/2 だけ異なりスーパーパートナーと呼ばれる超対称性粒子の存在を予言する。例えば、クォークやレ プトン(フェルミオン)のスーパーパートナーとして、スクォーク (\tilde{q}) やスレプトン (\tilde{l})(ボソン)があり、グルー オン(ボソン)のスーパーパートナーとして、グルイーノ(\tilde{g})(フェルミオン)がある。もし、この理論が正しけ れば、LHC では強い相互作用をするスクォークやグルイーノの対が大量に生成され、超対称性粒子の発見が期待 される。

R パリティ保存則を課すと、超対称性粒子は必ず対で生成され、次々と崩壊を繰り返す。崩壊仮定によっては比較的重いニュートラリーノ ($\tilde{\chi}_{2,3,4}^0$) やチャージーノ ($\tilde{\chi}_{1,2}^\pm$)が生成されることがある。そして、最終的に超対称性粒子のなかで最も軽い質量を持つ LSP(Lightest SUSY Particle)になる。この LSP の候補としては最軽量ニュートラリーノ ($\tilde{\chi}_1^0$)が考えられるが、この粒子は直接観測にかからない。しかし、解析に於いて消失横方向エネルギー E_T^{miss} として現れるので、ジェットと共に E_T^{miss} を指標として探索を行う。主な崩壊として以下の3つがある。

1. Multijets+ $E_T^{miss} \in - k$

$$\begin{split} \tilde{g} &\to q \tilde{q} \tilde{\chi}_1^0 \to \text{jets} + E_T^{miss} \\ \tilde{q} &\to q \tilde{\chi}_1^0 \to \text{jets} + E_T^{miss} \end{split}$$

2. 同符号の2 レプトン・モード

$$2\tilde{g} \to 2(q\tilde{q}\tilde{\chi}_i^{\pm}) \to 2(q\tilde{q}\tilde{W}^{\pm}\tilde{\chi}_1^0) \to 2(\text{jets} + l^{\pm} + E_T^{miss})$$

3.3 レプトン・モード

$$\tilde{\chi}_1^{\pm} \tilde{\chi}_2^0 \rightarrow l \nu \tilde{\chi}_1^0 + l l \tilde{\chi}_1^0 \rightarrow 3l + E_T^{miss}$$

3.1.3 超対称性 Higgs 粒子

超対称性理論の中で最も単純な MSSM(Minimal Supersymmetric extension of Standard Model) では、2 つの Higgs 2 重項が要求され、結果的に 5 つの Higgs 粒子が導入される。この 5 つはそれぞれ、 H^{\pm} (荷電スカラー)、h(中性軽スカラー)、H(中性重スカラー)、A(中性擬スカラー) である。これらの Higgs 粒子の質量は 2 つのパラ メーター tan β 、 m_A で表される。

以下に、MSSM 中性 Higgs 粒子の崩壊モードで観測が期待されるものを説明する。

1. $H/A \rightarrow \tau \tau$

標準 Higgs 粒子の場合はこのモードは分岐比が低く観測に適さないが、MSSM では高い分岐比が期待される。生成された 7 粒子の両方がレプトンに崩壊するチャネルと、一方はハドロンに崩壊するチャネルの2種類のモードが利用できる。

2. $H/A \rightarrow \mu\mu$

 $H/A \rightarrow \tau \tau$ に比べて、分岐比は $(m_{\mu}/m_{\tau})^2$ 倍低いが、精度よく測定が行えることから $\tau \tau$ モードでの測定を 補う役割が期待される。 3. $H \rightarrow hh$

崩壊モードは、 $hh \rightarrow bb\overline{b}$ が支配的だが、このモードでは効率の良いトリガーが行えないため、 $hh \rightarrow \gamma\gamma\overline{b}b$ チャネルで観測されることが期待される。イベントレートは低いが、2つの異なる Higgs 粒子の反応という 意味で非常に興味深い。

4. $A \rightarrow Zh$

2 つの Higgs 粒子が関係した反応として興味深い。 $Zh \rightarrow llb\bar{b}$ など Z の崩壊で生じる 2 つのレプトンでトリガーを行う方法が有効である。

3.1.4 その他の物理

ALTAS 実験の目的は上で述べた新しい素粒子現象の探索以外に標準理論の検証、ボトムクォークの精密検証、 QCD の精密検証などもある。

標準理論の検証はトップクォークの質量や部分崩壊率の測定などにより行われ、ボトムクォークの精密研究はボ トムクォークの稀崩壊現象を探索し標準理論を超える物理を探る手段として行われる。QCDの精密研究はクォー クに内部構造がないかということを高い横運動量を持つジェットの生成断面積の測定を通して行われる。

3.2 ATLAS 検出器

ATLAS 検出器は、全長 44m、高さ 22m、総重量 7000t の世界最大の検出器である。検出器の構成は、衝突点 に近い所から内部飛跡検出器、電磁カロリメータ、ハドロンカロリメータ、ミューオン検出器とつづく。これら を総合して、様々な陽子陽子衝突反応に対応し、超前方を除いた全立体角を覆い、ほぼ全ての粒子を検出する事 が可能となっている。

ATLAS 検出器における座標系は、ビーム軸を z 軸に取り、これに垂直な方向を r 方向、ビーム軸周りを周回す る方向に ϕ 方向を取った円筒座標系を採用する。また、衝突点から引いた線とビーム軸のなす角を θ とし、擬ラ ピディティ (pseudorapidity) η を

$$\eta = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{E + p_L}{E - p_L} \right) \simeq -\ln \left(\tan \frac{\theta}{2} \right)$$
(3.5)

と定義し、これを用いる。ここで、 p_L は生成粒子のビーム軸に沿った縦方向運動量 ($p_L = p_z$) である [13]。 衝突点に近い側から各検出器の概要を述べ、TGC が置かれる ATLAS 検出器の要素を説明する。



Fig. 3.5: ATLAS Detector [7]

3.2.1 内部飛跡検出器

荷電粒子のトラッキングを行う内部飛跡検出器は衝突点に最も近い位置に設置され、中央ソレノイドの約2T の磁場によって運動量の測定を行う。中央飛跡検出器は、次の検出器から構成される。

Pixel Detector 最内層にある半導体検出器。1pixel が 50µm × 300µm の位置分解能を持つ。

SCT(SemiConductor Tracker) シリコンマイクロストリップと称される、細長い有感領域を持った半 導体検出器である。

TRT (Transition Radiation Tracker) 半径 4mm のストローチューブ検出器であり、トラッキングの他 に遷移放射を利用した電子識別を行う。最外層に設置される。

これらの検出器により、反応直後の粒子の飛跡測定、短寿命粒子の崩壊点の検出などが行われる。



Fig. 3.6: 内部飛跡検出器 [1]

3.2.2 カロリメーター

超伝導ソレノイドの外側に電磁カロリメータ、ハドロンカロリメータが配置される。電磁カロリメータは鉛と 液体アルゴンのサンプリングカロリメータである。ハドロンカロリメータは鉄とシンチレータをタイル状に並べ たタイルカロリメータをバレル部に用いる。エンドキャップ部には銅と液体アルゴンによるもの、タングステン と液体アルゴンによるものを用いる。ここで粒子の識別や位置測定、エネルギーの測定が行われる。



Fig. 3.7: カロリーメータ [1]

3.2.3 超伝導空芯トロイドマグネット

Fig.3.8 のように、8 個の超伝導コイルをビーム軸回りに対称に配置し、トロイダル磁場を形成する。この磁場 でミューオンの軌道を曲げる事により運動量の測定・選別を行う。多重散乱を抑えるために空芯になっている。 Fig.3.9 はビーム軸に垂直な断面での磁力線を表したグラフである。このような磁場により r 方向にミューオンの 軌道が曲げられる。トロイダル磁場が完全ではなく、 ϕ 方向成分も持ち、ミューオンは ϕ 方向にも少し曲げられ る。磁場による r 方向の曲がり具合でミューオンの運動量を測定するが、精密測定には ϕ 方向の曲がりも考慮す る必要がある。



Fig. 3.8: 超伝導空芯トロイドマグネットの配置 [1]



Fig. 3.9: エンドキャップトロイドの中央 (z=1050cm) におけるトロイダル磁場 (磁力線) [1]

3.2.4 ミューオン検出器

衝突点で生成したミューオンは、他の粒子に比べ透過性が高いため (Fig.3.10)、ミューオン検出器は、Fig.3.11 に示すように ATLAS 検出器の最も外側に配置される。ATLAS 検出器に設置されるミューオン検出器には、運 動量の精密測定のための MDT、CSC、トリガー信号生成のための RPC、TGC が用いられる。



Fig. 3.10: 粒子の透過性の違い



Fig. 3.11: ミューオン検出器 [1]

3.2.4.1 MDT(Monitored Drift Tube)

MDT は Fig.3.12 に示すように、直径 30mm の Drift Tube を俵積みにし、フレームに固定した構造をしている。混合ガスは $Ar: N_2: CH_4 = 91: 4:5$ で混合されたガスが 3 気圧で用いられ、印加電圧は 3270V で動作する。最大 Drift Time は 500ns、位置分解能は 80 μm である。MDT は $|\eta| < 2$ のバレル・エンドキャップ部分に配置される。

Parameter	Design Value
混合ガス	$Ar: CO_2 = 97:3$
ガス圧	3bar(絶対圧)
印加電圧	3270V
位置分解能	$80 \mu m$

Table 3.1: MDT の各種パラメータ [1]



Fig. 3.12: Monitored Drift Tube [1]

3.2.4.2 CSC(Cathode Strip Chamber)

CSC は Fig.3.13 の構造をした、Cathode 読み出しの MWPC である。混合ガスとしては、 $Ar : CO_2 : CF_4 = 30 : 50 : 20$ で混合されたガスが用いられ、印加電圧は 2600V で動作し、位置分解能は $60\mu m$ 、Drift Time は 30ns 以下である。CSC はバックグラウンドとしてミューオン測定の妨げになる中性子への感度が 10^{-4} 未満と小さく、 γ 線に対する感度も 1% 程度となっている。そのため、最も放射線強度の高い超前方 ($|\eta| > 2$) に設置される。

Parameter	Value
ワイヤー間隔	$2.54\mathrm{mm}$
Anode-Cathode 間隔	2.54mm
印加電圧	2600V
混合ガス	$Ar: CO_2: CF_4 = 30: 50: 20$
ガスゲイン	4×10^4

Table 3.2: CSC の各種パラメータ [1]



Fig. 3.13: Cathode Strip Chamber [1]

3.2.4.3 RPC(Resistive Plate Chamber)

RPC は $|\eta| < 1$ の Barrel 部をカバーするトリガ用検出器である。RPC の特徴は、Anode に Wire を用いない ガスチェンバーであることで、2 枚の並行する Bakelite 板の間のガス ($C_2H_2F_4$) に数 kV/mm の電場を印加し、 信号は Strip から読み出す。RPC は Strip が直交するように重ねられ、2 次元読み出しが可能である。

Parameter	Value
ガスギャップ	$2.00\pm0.22mm$
印加電圧	$8.90\pm 0.15 kV$
Bakelite Volume Resistivity	$(1-5) \times 10^{10} \Omega cm$
カーボン面抵抗	$100 \pm 40 k \Omega$
混合ガス	$C_2H_2F_4:C_4H_{10}=97:3$
ガス圧	$(1.0 \pm 0.5)mb$

Table 3.3: RPC の各種パラメータ [1]



Fig. 3.14: Resistive Plate Chamber [1]

3.2.4.4 TGC(Thin Gap Chamber)

TGC は、 $2.4 < |\eta| < 1.05$ のエンドキャップ部分に設置されるトリガー用検出器である。TGC の構造は MWPC(MultiWire Proportional Chamber)で、Anode Wire と Cathode Strip のシグナルを読み出すことにより、 2 次元の位置測定が可能である。詳細については 4 章において述べる。

Parameter	Value
Anode-Cathode 間隔	1.4mm
Wire-Wire 間隔	1.8mm
印加電圧	3000V
混合ガス	CO_2 : n-Pentane = 55 : 45
ガス増幅率	10^{6}
位置分解能	~ 1cm
時間分解能	25nsのゲート幅に対して 99%の検出効率

Table 3.4: TGC の各種パラメータ [1]





3.3 ミューオントリガーシステム

LHC 加速器による 40.08MHz のバンチ交差により、ATLAS 検出器の衝突点で発生する陽子陽子の衝突率は 1GHz にもなる。これらの多量なイベントの中から目的とする物理現象のイベントを同定し、その現象由来のシグ ナルを探し出す必要がある。トリガーシステムは、これらの膨大なイベントの中からオンラインで、目的とする物 理事象を含むイベントのみを収集するための判断を行う。最終的に DAQ システムに送られるイベントレートは、 データストレージの容量の関係で 100Hz 程度にする事が要求されている。この目的を達成するために、ATLAS 実 験のトリガーシステムは3段階のステージに分け順次イベントレートを落としていく設計になっている (Fig.3.16)

初段がレベル1トリガーで、カロリメータとミューオンシステムにより行われる。この時、粒子が入射してい る検出器の領域を Region of Interest として指定する。これが次段のレベル2トリガーへ渡される。Region of Interest のデータを用い、さらに精密な選択を行う。最後にイベントフィルタがあり、ここでは検出器の全デー タを用いてイベントの選択が行われる。



Fig. 3.16: ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11]

3.3.1 レベル1エンドキャップミューオントリガー

TGC は上記の各トリガーのうち、End-Cap 部分のミューオンレベル1トリガーを担当する。Fig.3.17に TGC の配置を示す。TGC は2 層ないし3 層で1Unit となっており (Fig.3.20)、それぞれ Doublet、Triplet と呼ばれる。 TGC は衝突点から見て、Troid Magnet の外側に、Triplet(M1)、Doublet(M2)、Doublet(M3) の順で、BigWheel と呼ばれる円盤上に配置される。中央の Doublet を Middle Doublet、外側の Doublet を Pivot Doublet と呼ぶ。 Troid Magnet の内側には、Inner Station と呼ばれる Doublet が置かれる。

ミューオントリガーシステムとしての条件は

- *p_T* > 20*GeV* のミューオンが1つ存在
- *p_T* > 6*GeV* のミューオンが 2 つ存在

である。TGC でのミューオントリガーは、トロイド磁場での曲がり具合を、M1、M2、M3の3層での位置測定 で判定し、これより横運動量 (p_T) を求める。 $p_T = 6GeV$ 以上のミューオンの飛跡に対して、M2、M3の内少な くとも3層の検出器の hit を要求し、さらに M1の3層のうち2層を要求し、hit の位置からミューオンの運動量 を測定する。これらの hit パターンより $p_T = 20GeV$ 以上のトラックを選別し、Higgs 粒子等の探索に用いられ る (Fig.3.21)。

トリガーチェンバーである TGC に要求される条件として、



Fig. 3.17: エンドキャップミューオントリガー [1]



Fig. 3.18: M1 ステーションの TGC の配置 [1]



Fig. 3.19: M3 ステーションの TGC の配置 [1]

- 1. 検出効率が 99%以上である。
- 2. LHC のバンチ間隔である 25nsec 以下の時間分解能を持ち、バンチの決定が可能である。
- 3. *p*_T をトリガー条件に組み込むため、~1cm の位置分解能を持つ。
- 4. ATLAS 実験ホール内での、0.1kHz/*cm*²~1kHz/*cm*² の高頻度入射粒子環境下において、10年間安定に動 作する。

がある。これらの条件に対する様々な動作研究がこれまでに行われており [15] [16] [17] [18]、要求された性能を 持つことが確認されている。



Fig. 3.20: Doublet / Triplet 断面図 [1]



Fig. 3.21: トリガースキーム [11]

4 Thin Gap Chamber (TGC)

Thin Gap Chamber は、高エネルギー実験においてよく使用される Multi Wire Propotional Chamber(MWPC) 型の検出器の一つである。Anode Wire と Cathode Plane の間隔 (Gap) が通常の MWPC に比べ非常に狭いた め、Thin Gap Chamber(TGC) と呼ばれる。TGC は、Majewski、Charpak らによって、高頻度入射粒子状況下 でも動作できるチェンバーとして提唱された [12]。Anode Wire と Cathode Plane の間隔を狭くする事により、 入射粒子によって形成された陽イオンが早く Cathode Plane に到達し、チェンバーの不感時間 (Dead Time) が 短くなるよう設計されている。

4.1 動作原理

4.1.1 ガス増幅と動作モード

TGC に入射した荷電粒子は、その飛跡に沿ってガス中の分子と多数衝突し、イオン化させる (Fig.4.1(a))。電離された電子 (1 次電子) は、陽極へ Drift しながら、印加電場によって加速され、運動エネルギーを持つようになる。電子のエネルギーがガス分子の電離エネルギーを超えると、ガス分子をイオン化し、2 次電子を生成する (Fig.4.1(b))。一般に、その電場の閾値は1 気圧で約 $10^6V/m$ 程度である。2 次電子も電場によって加速され、それ が次々と衝突、電離を繰り返し、タウンゼント型電子なだれと呼ばれるカスケード形の電子なだれを形成する。この過程をガス増幅という。電子とイオン雲はそれぞれ Drift を始めてお互いに離れ (Fig.4.1(c))、電子雲は Anode Wire を取り囲み (Fig.4.1(d))、イオン雲はさらにその周りを取り囲むように Anode Wire 半径方向に拡散していく (Fig.4.1(e))。TGC はこの電子なだれをシグナルとして Anode Wire から読み取り、Anode Wire の位置から、位置情報を得る。



Fig. 4.1: Anode Wire 近傍でのタウンゼント型電子なだれの推移 [14]

$$\frac{dn}{n} = \alpha dx \tag{4.1}$$

で、式 (4.1) をタウンゼントの式 (Tawnsend Equation) という。α はタウンゼントの第一電離係数と呼ばれ、 電場と圧力、および気体の種類によって変わる係数である。電場が空間的に一定であり、圧力も一定であると仮 定すると、α は定数とみなすことが出来、

$$n = n_0 exp(\alpha x) \tag{4.2}$$

のように、電子の数nが初期の電子数n0に比例した関係にあることがわかる。

よって、印加電圧とチェンバー内の圧力をある範囲に設定すると、収集電荷を入射放射線によって生成された 最初のイオン対数に比例させる事が出来る。この領域を比例モード (Propotional Mode) という。一方、電離に よって生じた陽イオンは、移動度が電子に比べて非常に小さいため、電子を収集する間にはほとんど動かない。 したがって、チェンバー内には陽イオンの雲が出来、それがゆっくり陰極へ向かって拡散していく。印加電圧を あげていくと、この陽イオン雲の濃度が高くなり、空間電荷を形成してチェンバー内の電場をゆがめ、電子なだ れの成長を抑制するようになる。収集電荷が最初のイオン対の増加によって増大するが、直線性を示さない事よ りこの領域の動作モードを制限比例モード (Limited Propotional Mode) という。

さらに印加電圧をあげていくと、陽イオンによる空間電荷が完全に支配するようになる。電子なだれと共に生 成された陽イオンの濃度が高くなると、ガス増幅を起こす閾値以下に電場が下がってしまい、そこで電子なだれ の生成は終了する。この過程は自己制限型で、収集電荷は最初に生成するイオン対の数に関係なく一定である。 ここで入射放射線は分子を電離する事以外に励起も起こす。励起した分子は、可視、あるいは紫外線を放射して 基底状態へ戻る。これらの紫外線もエネルギーが十分高ければ、電離能力を持ち、別の電子なだれを生成する。 印加電圧が高くなると紫外線光子数も増加し、連続的に電子なだれが形成され、やがてチェンバー全体で放電す るようになる。この連続放電は、電場がガス増幅の閾値以下になった時に止まる。このときの収集電荷は、最初 に生成するイオン対の数に無関係で一定である。これをガイガーミューラー動作モード (Geiger-Müller Mode、 GM Mode) という。

このとき、紫外線吸収能力の高い混合ガスを使用すると、最初の電離(励起)が起こった位置からはなれた場所の電子なだれの生成を抑制する事が出来る。紫外線光子は電子なだれのすぐ近傍で、追加的な電子なだれを形成し、Anodeから Cathode の方向に電子なだれが成長すると、先端部の電子なだれから陽極に達し、この部分から急激に電流が流れ、後方の電子なだれへと柱状に伝わりスパーク放電する。これが制限ストリーマーモード (Limited Streamer Mode)、または自己消滅型ストリーマー(Self-Quenched Streamer Mode)である。

1MeV と 2MeV の荷電粒子に対する、印加電圧と各モードにおける出力パルス波高 (すなわち捕獲した電子数)の関係を Fig.4.2 に示す。

4.1.2 充填ガス

TGC はトリガーチェンバーであるため、入射粒子のエネルギーに関係なく入射粒子を全て検出出来なければな らない。それには制限比例モードで動作させる事が望ましい。制限比例モードで動作させる事は、比例モードと比 べてガス増幅によって得られる電荷量が 10~100 倍と大きく有利である。また、検出効率を 100 %に近づけるため には、入射荷電粒子による電離で発生した電子の捕獲確率が低い気体の方が望ましい。この点で、電子捕獲確率が 非常に小さい CO_2 が選ばれた。また、ガス増幅率が高くなると、紫外線による電離の影響が無視できなくなるた め、紫外線吸収能力の高いクエンチガスも必要となる。クエンチガスとしては、n-Pentane が選ばれた。n-Pentane は非常に大きな紫外線吸収能力をもち、吸収した紫外線のエネルギーを分子自身の回転エネルギーやラディカル 等の低分子への解離エネルギーに使用し、2 次電子の放出を抑える働きをする。0.5 気圧、室温で用いることが 可能なアルカン系のガスの中で、紫外線の吸収断面積が最大である (Fig.4.3)。このことから、 CO_2 + n-Pentane の充填ガスを用いると、高い増幅率と高い検出効率を得る事が出来る。ガス混合率は CO_2 :n-Pentane=55:45 と なった。



Fig. 4.2: 各動作モードにおける印加電圧と出力パルス波高の関係



Fig. 4.3: n-Pentane の紫外線吸収断面積

気体	電子捕獲確率			
CO_2	6.2×10^{-9}			
O_2	2.5×10^{-5}			
H_2O	2.5×10^{-5}			
Cl	4.8×10^{-4}			

Table 4.1: 各種ガスによる電子捕獲確率の違い

4.2 TGCの構造

TGC の断面図を Fig.4.4 に示す。TGC は、1.6mm 及び 1.8mm の FR4(ガラスエポキシ樹脂)を基板として、その片面にカーボンを塗布することで、Cathode 面を形成している。Anode Wire は直径 50µm の金メッキタングステンワイヤーが用いられている。Wire-Wire 間隔は 1.8mm であり、これによって 25nsec の時間分解能が実現される。また、Anode-Cathode 間隔は 1.4mm と通常の MWPC に比べ狭くなっており、陽イオンが早く cathode に到達することにより、粒子の高レート入射に対して耐性をもつ。さらに、Wire-Wire 間隔と Anode-Cathode 間隔がほぼ同程度に狭いことにより、電子なだれの領域が広く取れる構造になっている。TGC の電場・電位構造をFig.4.7 に示す。電場は Wire 近傍において 1/r で増加し、Wire から 0.2mm の位置では約 40kV/cm の電場を持ち、Cathode 面近傍 (Wire から 1mm)の位置でも 10kV/cm を持つ。このように TGC は全領域にわたり非常に強い電場を持ち、ほぼ全領域でガス増幅が可能な構造を持つ。

陽イオンが Cathode 面に衝突した際に、電子がチェンバー内に飛び出さないよう仕事関数が大きく、かつ紫外線によって光電効果を起こさないよう原子番号の小さい物質が Cathode 面には適しており、カーボンを塗布した面が選択された。カーボンを塗布する事で、放電を抑える事が出来、さらに高抵抗にする事により、Strip 間のクロストークを抑える事が出来る。しかし、抵抗が高すぎると、局所的な電圧降下の影響を受けたり、チャージアップを起こしたりするので、均一にかつ $0.5M\Omega \sim 1.5M\Omega$ の範囲になるよう調整しなければならない。

Fig.4.5 に、T7 タイプの TGC の平面図を示す。TGC には 2 種類のスペーサーが入っており、一つは Wire の たるみを防ぐためのワイヤーサポートで、もう一つはギャップ間隔を一定に保つためのボタン型サポートである。 これらのスペーサーは不感領域となるが、Doublet/Triplet にする際、これらの不感領域が重ならないように、モ ジュール内の TGC 間でワイヤーサポートの位置は半ピッチずつづれるよう製作される。Wire と Strip の両読み 出しをする事で 2 次元での位置情報を得る事が出来る。Wire は r 方向の情報を、Strip は ϕ 方向の情報を得るよ う配置される。T7 タイプの場合、Wire-Wire 間隔が 1.8mm で張られるため、1 枚あたり約 700 本の Wire が張 られる。このため、~ 20ch を 1 グループとして読み出しを行う (Fig.4.6)。Strip に関しては、~ 40mm 幅の Strip がチャンネルの数だけ刻まれている。



Fig. 4.4: TGC の構造 (断面図) [1]



Fig. 4.5: TGC の構造 (平面図)



Fig. 4.6: Wire 方向の読み出し部分の構造 [1]



Fig. 4.7: TGC の電場 (左)・電位 (右) 構造のシミュレーション [16]

4.2.1 ASD(Amplifier Shaper Discriminator) Board

ASD Board は TGC の側面に取り付けられ、4 チャンネル分の処理が出来る ASD ASIC(Fig.4.8) が 4 個搭載 され、1 つのボードで 16 チャンネルを処理する。ASD ASIC は、TGC からのアナログ信号を増幅、整形し、あ る閾値電圧を越えた信号だけを LVDS(Low Voltage Differential Signaling:低電圧作動信号)レベルの信号で出力 する。ASD ASIC に入力された電荷量はプリアンプで 0.8V/pC に従って電圧値に変換され、メインアンプ (*G*7 と書かれた部分)で 7 倍に増幅される。プリアンプに 0.1 から 0.5pC の電荷を入力したときの出力を Fig.4.9 に 載せる。メインアンプで増幅されたシグナルはサーキット回路 (offset setting と書かれた部分) に入り、外部から 指定された閾値を超えた信号について出力される。また、ASD Board 以降のエレクトロニクスの診断やタイミ ング調整のために、トリガー信号を受けて、擬似的な TGC の出力信号 (Test Pulse)を出力する機能も持ってい る。ASD Board は、ツイストケーブルで後続のボードに接続され、動作電源、閾値電圧を決定されて動作する。 また、ASD Board には 16 チャンネル目のアナログ信号をモニタできるアナログ出力もついている。Fig.4.10 は ASD Board の写真である。



Fig. 4.8: ASD ASIC 回路図



Fig. 4.9: オシロスコープで見た 0.1pC から 0.5pC までの入力に対するプリアンプの外部出力



Fig. 4.10: ASD Board

4.3 中性子の信号による TGC への影響

4.3.1 中性子の性質

4.3.1.1 中性子の発生

中性子は陽子とともに原子核を構成する粒子で陽子とほぼ同じ質量を持つが、単独で安定に存在することは出 来ず、半減期13分で 崩壊して陽子に変わってしまう。このため、人為的に加速器か原子炉を用いて作らない限 りは単独では自然界には存在しない。核融合反応や、加速した陽子をターゲットに当て、ターゲット物質内の原 子核と陽子のスポレーション反応(核破砕反応)が起きる過程で発生する。

4.3.1.2 中性子と物質の相互作用

中性子は電荷を持たないので、物質との相互作用はスピンによる磁気的相互作用か、核力によるものである。 核力はその及ぶ範囲が10⁻¹³cmと非常に小さく、衝突の断面積は10⁻²⁴cm² 程度となっている。

中性子が物質に入射した際に物質内の原子核と起こす反応は、中性子のエネルギー領域によって以下の3通り に分けられる。

(1) < 1MeV

中性子は原子核に吸収され、原子核を励起状態にする。 励起状態になった原子核は、基底状態に落ちる際に を出す。

(2) $1 \sim 100 M eV$

中性子は原子核と衝突し、スポレーション反応や散乱によって陽子、原子核を出す。

(3) > 100 M eV

中性子は核力の影響を受けずに原子核内の陽子、中性子(、核子 N)と反応する。反応によって π 中間子が 生成されるとともに、反跳核子、半跳原子核が観測される。

$$n + N \to n + N' + \pi \tag{4.3}$$

(4) ~ **数** GeV

このエネルギー領域でのスポレーション反応では、核子同士の多重衝突が短時間で起こり、高いエネルギー を持った核子が放出され、残された高励起状態の高温複合核から粒子蒸発が激しく起こり、標的核がばらば らになる。

4.3.2 中性子の TGC に対する影響

中性子とTGCを構成する物質との相互作用で発生した陽子がTGCのガス内に放出されると、Bethe-Blochの 式に従ってガス内にエネルギーを落とす。そのときの陽子のエネルギーと単位長さ当りのエネルギー損失のグラ フを Fig.4.11 に載せる。このグラフから分かるように、1*MeV*以下の陽子によるエネルギー損失は非常に大き く、したがって MIP(Minimum Ionization Particle)による信号と比べ、大きな信号が生成される。こういった中 性子による信号によって引き起こされる可能性のある TGC の異常動作には、早期劣化、クロストークが考えら れる。早期劣化は、中性子の大きな信号による放電の頻発によって起こる可能性がある。

放電は次のように起こる。粒子による信号により TGC に流れる電流は、イオン対数、素電荷、ガスゲイン、入 射レートの積で表される。TGC 内で大きな信号が生成されイオン量が多くなると制限ストリーマーモードに入 り、数 $\mu A \sim +$ 数 μA のリークカレントが流れる。ちなみに通常 TGC のリークカレントは数 $nA \sim$ 数+ nA であ る。これにより TGC 内の電場に影響を及ぼす場合もある。さらに大きな信号が生成された場合や、さらに高レー トで粒子が入射するとストリーマーモードに移行し、放電が起こる。中性子は TGC 内で大きな信号を生成する 可能性があり、高頻度中性子バックグラウンド環境下では放電が頻発する可能性が考えられる。



Fig. 4.11: 粒子の持つ運動量と dE/dx:横軸が粒子の運動量、縦軸が dE/dx を表す。p、 π 、K、 μ の4 粒子についての運動量とエネルギー損失を表す。

クロストークとは、本来信号を出すべきでないワイヤーもしくはストリップがなってしまうというもので、次 のように起こる。入射粒子により電離された電子が近くのワイヤー(W1)に到達すると、W1には局所的に負の 電荷が集まっていることになる。もともとワイヤーワイヤー間、ワイヤーとカソードストリップ間には電気的な 容量が存在するため、W1付近のワイヤーにはそれぞれW1との容量にしたがってW1とは逆符号の信号が生成 される。ワイヤーの読出しに使われるASDには閾値が設定されており、逆符号の信号はカットされるため問題 ないのだが、中性子による信号は非常に大きく、信号のアンダーシュートがその閾値を超えてしまう場合がある。 このため、W1以外のワイヤーからも信号が出てしまうことになる。カソードストリップにも同じことがあては まる。この偽シグナルにより、ATLAS実験本番において偽トリガーを生成してしまう恐れがある。

5 中性子照射試験

5.1 中性子源

実験には、日本原子力研究所の施設の1つである FNS(Fusion Neutronics Source)の中性子源を使用した。FNS の鳥瞰図を Fig.5.1 に示す。また、FNS に設置されている中性子発生装置の各パラメータを Table5.1 に、0 度、80 度ビームラインでの各パラメータを Table5.2 に示す。図中の 400keV 重陽子加速器により重水素(D:Deuteron) を発生させ、ターゲットに向けて走らせる。加速器はコックロフト加速器で、2 つの電極の間に高い電圧をかけ、 それによってプラスイオンをまっすぐ加速する。ビームラインは加速器から考えて0 度 方向と 80 度 方向の2 方 向に設けられており、それぞれ Table5.2 のビーム電流、中性子発生量を得られる。ターゲットの交換も可能で、 Deuteron と Toritium を選択することが出来、以下の2 つの反応に従ってそれぞれ 2.5*MeV*、14*MeV* の単色中 性子を発生させることが出来る。

(1) 2.5*MeV* 単色中性子の発生

$$D + D \rightarrow {}^{3}He + n + 3.27MeV \tag{5.1}$$

(2) 14*MeV* 単色中性子の発生

$$D + T \to {}^{4}He + n + 17.6MeV \tag{5.2}$$

ビームのタイプには、

(1) DC モード

ターゲットにビームを断続的に当て、断続的に中性子を発生させる。

重照射に適している。

(2) パルスモード

ビームを一定間隔で区切って圧縮し、バンチ化してターゲットに当てる。

ビームのタイミングが把握できる。

があり、目的に応じてどちらも使用できる。DC モードは加速劣化試験、出力電荷量の測定、放電レートの測定に、パルスモードはクロストークイベントレートの測定に使用した。ビーム電流 (ビーム強度) は短時間で変更 することが出来る。

今回の実験では、80度ビームラインを使用し、図中の実験体系部分にTGCをおいて測定した。

形式	400keV 重陽子加速器	バンチ間隔	24.95 nsec			
直流高圧電源	450kV, $80mA$	パルス最小幅	2ns			
イオン源	体積型イオン源 (大電流用)、デュオプラズマトロン (小電流用)					

Table 5.1: FNS 加速器概要



Fig. 5.1: FNS **鳥瞰図**

ビームライン	0度	80 度
ビーム電流	25mA	3mA
中性子発生量	$5 \times 10^{12} n/s$	$5 \times 10^{11} n/s$
トリチウムターゲット	回転ターゲット	固定ターゲット (水冷)
トリチウム装荷量	37TBq	3.7TBq

Table 5.2: 各ビームラインでのパラメータ

5.2 T7 タイプ TGC と小型 TGC

実験には、ATLAS 検出器として使用される TGC(以下大型 TGC)1 台と、大型 TGC と同じ材質で作った小型 TGC を使用した。

使用した大型 TGC のタイプは T7 の Doublet (4 章参照、Fig5.2) である。Fig5.2 の右辺、下辺に取り付けてあ る ASD (4.2.1 参照) より、1 層についてワイヤー 16 × 2 チャンネル、ストリップ 16 × 2 チャンネルの信号を読 み出す。Doublet なのでこれが 2 層あるのだが、今回使用した T7 は 2 層中 1 層が導通しており電圧をかけるこ とが出来ないため、片面のみ使用した。

小型 TGC についてはアノードワイヤーの間隔、アノードワイヤーとカソードプレーンの間隔も、大型 TGC を 再現した。大きさは 100 × 120mm で、長さ 80mm のワイヤーが 16 本張ってある。両端のワイヤーは他のワイ ヤーに対してドリフト領域が広く電場構造が異なるので、測定では両端 2 本と他のワイヤーをわけた。両端のワ イヤーを除いたガス有感領域は 80 × 25.2mm である。小型 TGC の概略図を Fig.5.3 に載せる。小型 TGC の読 出しはワイヤーのみである。







Fig. 5.3: 小型 TGC 概略図

5.3 実験セットアップ

2.5*MeV* 中性子照射試験 (2005 年 5 月)、14*MeV* 中性子照射試験 (2005 年 8 月) におけるビームターゲットの 位置と TGC の設置位置の関係を Fig.5.4 ~ Fig.5.5 に示す。研究項目は以下である。

- 大型 TGC を用いた研究
 - 1. 中性子ヒットに対するクロストークレートの研究
 - 2. 中性子による劣化の研究(加速劣化試験)
- 小型 TGC を用いた研究
 - 1. 中性子による出力電荷量の研究
 - 2. 中性子感度の研究
 - 3. 中性子ヒットによる放電レートの研究
 - 4. 中性子に耐性のある代替ガスの研究







Fig. 5.5: 14MeV TGC 設置位置 (加速劣化試験)



Fig. 5.6: 14MeV TGC 設置位置 (クロストークスタディ)

5.3.1 データ取得セットアップ

5.3.1.1 ADC を用いたデータ取得

使用した ADC は、ゲート間のアナログ信号の電荷量を積分し、その値を対応する 0~4000 のチャンネルに格 納する。この ADC を用いて、中性子による信号の TGC からの出力電荷量データを記録した。回路図を Fig.5.7 に示す。ADC はセルフトリガーモードで使用し、TGC からのデジタル信号を Gate generator を介して ADC の ゲート信号として入力した。ゲート信号と ADC に入力するアナログ信号のタイミングは、オシロスコープで確 認 (Fig.5.8) し、ゲート信号から~50*ns* 後にアナログ信号が ADC に入るように Delay 回路を用いて調整した。 ゲートの幅は、TGC からの出力パルスを全て収められるよう~500*ns* とした。(Fig.5.8)



Fig. 5.7: ADC データ取得回路図



Fig. 5.8: ADC 信号タイミング:上が TGC からのアナログシグナル (ADC に入力)、下が TGC からのデジタルシ グナル (ゲート信号)

TMC はある一定時間の間の信号の情報を記憶できる。これを用いて中性子ヒットに対するクロストークレート の測定を行った。今回使用した TMC は 1µs 間の信号の時間情報を記憶しておくことができ、コモンスタートモー ドではスタート信号から 1µs 間、コモンストップモードではストップ信号からさかのぼって 1µs 前までの間の入 力信号の時間情報を出力する。今回の実験ではコモンストップモードで使用した。回路図を Fig.5.9 に示す。TGC のヒット信号は ASD から読み出され、ASD Buffer を介してコインシデンスと TMC に送られる。ASD Buffer とは、ASD からの信号の読み取り用回路として開発されたモジュールで、背面に 2 個の 40 芯フラットケーブル 用のコネクタカードが装備されており、それぞれ 16 チャンネル ASD カードからのデジタル信号、アナログ信号 を入力できる。デジタル信号は ECL 信号に変換されて、アナログ信号は増幅されて出力される。また、ASD へ の閾値電圧、テスト信号、電源を供給する。

TMC のストップ信号には、ビームのターゲット付近に取り付けられているピックアップリングの信号とTGC のヒット信号のコインシデンスを取ったものを入力した。ピックアップリングにより中性子発生情報を取得し、中性子が発生した中で TGC にヒットがあったものについてデータをとれるようになっている。ストップ信号と TGC からのヒット信号のタイミングを Fig.5.10 に示す。



Fig. 5.9: TMC データ取得回路図



Fig. 5.10: TMC 信号タイミング:上が中性子のヒットシグナル、下が TMC のストップシグナル

TGC に電圧を与える高電圧電源は、TGC の安全を確保するため、設定値以上のリークカレントが一定時間流 れ続けると電源を落とすようになっている。また、TGC に印加中の電圧値、リークカレント値は高電圧電源から 取得することができ、アナログ電圧値として出力される。この電圧値を常時モニターし、中性子照射中の TGC のカレント状況を把握し、放電レートの測定を行った。カレントモニターシステムの回路図を Fig.5.11 に示す。 高電圧電源からの情報 (電圧値) はアンプを通して増幅され、ツイストケーブルで PC に接続されている AD ボー ド (Analog to Digital Converter Board) に入力さる。信号は AD ボード + Visual Basic で作成されたアプリケー ションによりデジタル値に変換されて記録される。AD ボードには AD12-64(PCI)を使用し、100*Hz* でのカレン トモニターシステムを構築した。AD12-64 には 64*Mbyte* のメモリが搭載されており、入力された情報は一旦そ のメモリに記憶される。メモリが搭載されていることで、より早い周期でのデータの取得が可能である。データ 読み込みの周期はプログラムで指定でき、別に指定する周期でメモリからのデータの吸い上げとメモリの初期化 を行う。+10V ~-10V までの入力に対応し、Fig.5.12 に従って 0~4096 のデジタル値に変換される。プログラム 内でさらに変換し、出力ファイルには印加電圧値、リークカレント値が出力されるようにした。



Fig. 5.11: モニターシステム図



Fig. 5.12: AD 変換表

5.3.1.4 ガス供給システム

ガスシステムの概略図を Fig.5.13 に載せる。図中の点線で囲まれた部分をピンクの部分にもうひとつ作り、ガ ス供給系を 2 系統設置した。各系統の流量はそれぞれフローメーターで記録されており、実験を通して 20*cc* ~ 40*cc* 内で値を決めてガスを流した。流すガスは各系統で別のものを選ぶこともでき、 CO_2 、 CF_4 を使用した。ガ スボンベから供給されるガスを恒温槽で液体の n-Pentane の中でバブリングさせて n-Pentane と混合させる。恒 温槽の設定温度を変えることで CO_2 、 CF_4 と n-Pentane の混合比を変えることが出来る。ガスの混合比は、TGC の後段にあるガスクロマトグラフを使い確認した。内圧の急上昇による TGC の損傷を防ぐために安全バプラー、 n-Pentane 回収装置として HCT (Hydoro Carbon Trap) を TGC の後段に設置した。各系統から TGC まではス テンレスパイプ (1/4 インチ) でガスを供給した。小型 TGC が 2 台ある場合はその 2 台を直列につないだ。



Fig. 5.13: ガスシステム図

5.4.1 中性子感度

FNS の 80 度ビームラインには、ターゲットから 179.1 度 の位置に SSD(silicon surface-barrier detector) が、 ターゲット後方の真空中にアルファモニターが取り付けられている。SSD によって中性子発生量は~2%の誤差 で測定され、MCS データという形で記録される。MCS データには、10秒間の中性子の発生量の和が 10秒毎に 記録されている。この値に適切なパラメータ (アルファモニター、SSD の位置、SSD の感度を含む)をかけるこ とによって、ターゲット位置での中性子発生量が導かれる [19]。このデータを使用し、ターゲットからの TGC の設置位置での立体角を考えて TGC に入射する中性子の量を算出した。MCS データから算出した中性子発生量 の分布の一例を表示したものを Fig.5.14 に載せる。

中性子感度は、TGCの中性子ヒット数を MCS データから見積もった TGC への入射中性子数で割ることで求めた。中性子ヒット数は、次の手順で計算した。TGC の出力電荷量分布の中性子のピークをガウシアンでフィットし、ピーク値と標準偏差を出す。 $\sqrt{2\pi} \times (\mathcal{C}- 2\pi) \times (\mathcal{R}^2 + \mathcal{R}^2)$ で出力電荷量分布中の中性子ヒットの割合が出る。これに全ヒット数である Scaler での計数値をかけると、その出力電荷量分布のデータを取得した間の TGC の中性子ヒット数が出る。なお、TGC の中性子ヒットには、20%前後の系統誤差が含まれている。中性子エネルギーが 2.5 MeV、14 MeV での中性子感度を Table5.3 に載せる。 $10^{10} \sim 10^{12}$ の中性子を当てたので、中性子感度から考えて $10^6 \sim 10^8$ のデータを取得したため、統計誤差は無視できる。結果を見ると、2.5 MeV より 14 MeV の方が中性子感度が、 CO_2 ベースのガスで約4倍、 CF_4 ベースのガスで約5倍と高くなっている。これは、TGC の中性子ヒットを求める過程で生じる誤差を考えると、ベースガスの違い、n-Pentane の混合比の違いによる中性子感度の違いはほとんど見られなかった。



Fig. 5.14: 中性子発生量:縦軸が10s 間の中性子発生量、横軸が時間

ガス	CO_2 +n-Pentane		CF_4+1	n-Pentane
混合比	55:45	70:30	55:45	70:30
2.5 MeV(%)	0.024	0.022	0.019	0.018
14 MeV(%)	0.083	0.085	0.10	0.10

Table 5.3: 中性子感度

5.4.2 出力電荷量

中性子照射試験に先立って、

1. TGC への入力電荷量と ADC からの出力値のキャリブレーション

2. 試験に使用する4種類のガスを使用し、TGCのMIPに対する出力電荷量の測定

を行った。

先ず1.について述べる。ADCから出力される値は、電荷量に対応した0~4000の値であり、この値から出力電 荷量に戻す必要がある。この変換係数は、中性子照射試験と同じセットアップを用いて次の方法で測定した。Pulse generator からの矩形波をコンデンサーを通して入力することで、任意の電荷量をTGC に入力できる。Fig.5.7 のセットアップで、TGC のワイヤーにコンデンサーをつなぎ、入力電荷量に対して出力される ADC 値を複数の 点で測定することで、ADC 値と電荷量の変換係数を導出した。その結果を Fig.5.15 に載せる。なお、ADC 値に ついては得られた出力電荷量分布 (ADC 値) の平均を取った値をプロットしている。実験では、この図に従って ADC 値から出力電荷量を求めた。なお、出力電荷量が 20*pC* の付近からグラフの傾きが変わるのは、使用したア ンプの特性によるもので、線形性は保たれているため、問題ない。

次に、2. を行った際のセットアップを Fig.5.16 に載せる。このセットアップで宇宙線ミューオンを用いて、TGC の MIP による出力電荷量を測定した。測定結果は Fig.5.17 となった。TGC への印加電圧が上がるにつれてガス の違いによる出力電荷量の差が大きくなる傾向にあるが、本来の動作電圧である 2.9kV 付近ではどのガスの場合 も大きな違いは見られなかった。



Fig. 5.15: ADC 値と電荷量の変換



Fig. 5.16: MIP による出力電荷量測定セットアップ



Fig. 5.17: TGC の MIP による出力電荷量

出力電荷量は、4 種類のガスについて TGC に印加する電圧を $2.7kV \sim 3.8kV$ の範囲で 0.1kV 毎に変えて、ADC を用いて測定した。この測定で、中性子のエネルギーによる出力電荷量の違い、TGC への印加電圧による出力 電荷量の違い CO_2 ベースのガスを用いた場合と CF_4 ベースのガスを用いた場合での出力電荷量の違い、 CO_2 、 CF_4 と n-Pentane の混合比による出力電荷量の違いについての研究を行った。

中性子による出力電荷量分布をFig.5.20~Fig.5.43に載せる。各ガス、各中性子エネルギーについて、TGC 印 加電圧が 2.7kV、3.0kV、3.3kVの場合の出力電荷量の分布である。ペデスタルのピークは取り除いてある。ま た、これらの分布中の中性子のピーク位置を Fig.5.18、Fig.5.19 に載せる。ピークの位置は、中性子のピークを ガウシアンでフィットし、その平均値を採用した。 γ の出力電荷量は MIP のそれにほぼ等しいことから、図中の 左のピークが γ のピークであり、右のピークが中性子のピークを表す。全てのガスで、TGC への印加電圧にか かわらず、2 つ存在する出力電荷量分布のピークがはっきりと区別できており、TGC が良い n- γ 弁別能力を持っ ていることが分かる。

中性子のエネルギーによる違いに着目すると、2.5MeVでは中性子のピークがはっきりしているのに対し、14MeVではその形が崩れ出力電荷量が広く分布しており、2.5MeVではほとんど表れなかった 20pC 以上の大きな出力電荷量成分が表れている。また、中性子のピーク位置は γ のピーク位置の 4 倍 ~ 20 倍程度で、その差は印加電圧に比例して大きくなり、特にその増加率は CO_2 で顕著に表れている。Fig.5.18、Fig.5.19 を見ると、 CO_2 ベースのガスの方が CF_4 ベースのガスに比ベピーク位置が 2~4 倍と大きく出ている。MIP による出力電荷量が CO_2 ベースガスと CF_4 ベースガスでかわらないこと (Fig.5.17)、 CF_4 ベースガスのピーク位置は中性子にエネルギーにかかわらず一定であること、印加電圧によるピーク位置の推移が CO_2 ベースのガスに比べ小さいことから、 CF_4 ベースのガスを使用すると中性子による信号が早い段階でサチュレートすると考えられ、中性子による大きな信号が出にくくなっていることが分かる。

n-Pentane を混入する比率について見てみると、n-Pentane を多く混入しているガスの方が出力電荷量のピーク が CO_2 で数%、 CF_4 で数十%低く出ている。このことは特に CF_4 で顕著に表れた。



Fig. 5.18: 2.5*MeV* 中性子の出力電荷量分布のピーク



Fig. 5.19: 14MeV 中性子の出力電荷量のピーク



Fig. 5.20: 2.5 $MeV \ CO_2$ 55:45 2.7 kV Fig. 5.21: 2.5 $MeV \ CO_2$ 55:45 3.0 kV Fig. 5.22: 2.5 $MeV \ CO_2$ 55:45 3.3 kV



Fig. 5.23: 2.5 $MeV \ CO_2$ 70:30 2.7 kV Fig. 5.24: 2.5 $MeV \ CO_2$ 70:30 3.0 kV Fig. 5.25: 2.5 $MeV \ CO_2$ 70:30 3.3 kV



Fig. 5.26: 2.5 $MeV \ CF_4 \ 55:45 \ 2.7 kV$ Fig. 5.27: 2.5 $MeV \ CF_4 \ 55:45 \ 3.0 kV$ Fig. 5.28: 2.5 $MeV \ CF_4 \ 55:45 \ 3.3 kV$



Fig. 5.29: 2.5MeV CF₄ 70:30 2.7kV Fig. 5.30: 2.5MeV CF₄ 70:30 3.0kV Fig. 5.31: 2.5MeV CF₄ 70:30 3.3kV



Fig. 5.32: $14MeV\ CO_2\ 55:45\ 2.7kV$ Fig. 5.33: $14MeV\ CO_2\ 55:45\ 3.0kV$ Fig. 5.34: $14MeV\ CO_2\ 55:45\ 3.3kV$



Fig. 5.35: $14MeV\ CO_2\ 70:30\ 2.7kV$ Fig. 5.36: $14MeV\ CO_2\ 70:30\ 3.0kV$ Fig. 5.37: $14MeV\ CO_2\ 70:30\ 3.3kV$



Fig. 5.38: $14MeV\ CF_4$ 55:45 2.7kV Fig. 5.39: $14MeV\ CF_4$ 55:45 3.0kV Fig. 5.40: $14MeV\ CF_4$ 55:45 3.3kV



Fig. 5.41: 14 $MeV\ CF_4$ 70:30 2.7kV Fig. 5.42: 14 $MeV\ CF_4$ 70:30 3.0kV Fig. 5.43: 14 $MeV\ CF_4$ 70:30 3.3kV

放電レートの測定は、1 つの電圧について 10 分以上中性子を照射し続け、その間チェンバーへ流れた電流の推 移を観測することにより行った。モニターデータには、データ取得時の時間も記録されており、この時間と MCS データの時間とを照らし合わせ、各電圧についてモニターデータから中性子照射中のデータを抜き出し、その電 圧で TGC を動作させた間の中性子数を計算して、中性子1個入射時の放電確率を出した。10分間の TGC の有 感領域への中性子入射数は2.5*MeV* で 4.2 × 10¹⁰ 程度、14*MeV* で 1.4 × 10⁹ 程度である。放電レートは、カレ ントモニターの値に閾値を設け、Fig.5.44 のように放電が起こった中で、 $3\mu A$ を超えたものを放電と定義し、そ の回数をカウントすることで算出した。カレント値が 3µA を超えてから 3µA 以下になるまでを一回の放電とし た。2.5*MeV*、14*MeV* それぞれの中性子照射時の放電レートを Fig.5.45、Fig.5.46 に載せる。図には、放電が起 こった電圧のみプロットしてある。それぞれの中性子エネルギー、それぞれのガスに関して Fig.5.45、Fig.5.46 に載せた電圧より低い電圧でも測定したが、放電は起こらなかった。図を見ると、2.5MeV に比べ 14MeV の方 が、放電が始まる電圧がどのガスでも低い。これは、14MeVの出力電荷量分布に見られる出力電荷量の高い成分 によるものだと考えられる。また、CF4 を混ぜたガスの方が放電が起こりにくくなっている。これは、中性子に よる出力電荷量が CO₂に比べ、CF₄の方が小さく、生成される信号が CF₄の方が小さいためだと考えられる。 n-Pentane に関しては、やはり紫外線のクエンチ能力の高さが表れており、多く混入した方が放電は起こりにく くなっている。実験を通して TGC に電圧を供給する高電圧電源がトリップするような大きな放電 (リークカレン ト> $10\mu A$) は観測されなかった。



Fig. 5.44: カレントモニターディスプレイ



Fig. 5.45: 2.5*MeV* 中性子照射時の放電レート



Fig. 5.46: 14MeV 中性子照射時の放電レート

5.4.4 クロストーク

クロストークイベントの測定にはパルスモードの中性子ビームを使用した。パルスモードでは、中性子がバン チ状に TGC に入射するので、TGC に入射する中性子のタイミングの把握が容易にできるため、各中性子ヒット に対する TGC の応答を観測するのに適している。ターゲット付近のピックアップリングから中性子の発生タイ ミングを取得し、TOF(Time of Flight) 法により即発 γ と中性子を区別し、中性子ヒットに合わせてトリガーを 行った。2.5*MeV*、14*MeV* それぞれの中性子エネルギーでのパルスモードのビームのパラメータを Table.5.4 に 載せる。また、Fig.5.47、Fig.5.48 はワイヤーからの信号で見た 2.5*MeV*、14*MeV* での中性子、即発 γ の TGC への到達時間分布である。横軸はストップ信号からの時間を表し、0 がストップ信号が TMC に入った点で、そ こから x 軸の正の方向へ時間をさかのぼっていく。右側にあるピークが即発 γ 、左側が中性子のピークである。 はっきりと、中性子と γ を識別できている。

	2.5 M eV	14 M eV
中性子発生量 (DC)	$10^9 n/smA$	$10^{11}n/smA$
パスル幅	_	5ns
繰返し周期	$17\mu s$	$17 \mu s$
中性子強度	2.8mA(ピーク値)	



Table 5.4: パルスモード各種パラメータ



Fig. 5.48: 14*MeV* の中性子、即発 γ の到達時間

TMC で取得したデータの表示例が Fig.5.49 である。上から Layer1 のワイヤー (W1)、ストリップ (S1)、Layer2 のワイヤー (W2)、ストリップ (S2) の順にヒットのタイミングを表す。横軸が、ストップ信号が TMC に入った 時点から 1 μ s 前までの時間を表し、0 の点がストップ信号の時間を表す。右に行くほど時間をさかのぼり、1 μ s 前 までのヒット情報を表示する。ヒットがあれば Fig.5.49 のようにヒットのあったチャンネルのヒットのあった時 間に赤い印が表示される。電圧をかけているのは Layer1 のみなので、通常のイベントであれば Fig.5.49 のよう に W1 と S1 の中性子入射位置に該当する位置にのみ信号が出る。

取得したデータの中で、クロストークを起こしているイベントが観測された。表示例は Fig.5.50 のようになる。 W1 に複数のヒットが見られることから、中性子による大きな信号が生成されたことが分かる。この信号により、 クロストークが起こり、S1 では全チャンネルが信号を出している。また、電圧がかけられていない Layer2 の W2、 S2 にも信号が現れている。このようなクロストークイベントの中で、Fig.5.50 の S2 のように、クロストークが 全チャンネルに広がっているものをマルチヒットと呼ぶことにする。動作電圧と信号の閾値を ATLAS 実験本番 で予定されているものと同じにして以下のデータを集めた。

- マルチヒットイベントレート
 中性子ヒットがあり、かつ W1 もしくは S1 の 15 チャンネル以上に 200*ns* 以内にヒットがあるイベントの
 レート。
- クロストークイベントレート
 中性子ヒットがあり、かつ W2 もしくは S2 にヒットがあるイベントのレート。

なお、W1 と S1 の両方に 15ns 以内にヒットがあるものを中性子ヒットとした。クロストークヒット、マルチ ヒットイベントのレートを Table5.5 に載せる。

W1 にマルチヒット	0.24 ± 0.14	S1 にマルチヒット	37 ± 1.4
W2 にクロストークヒット	6.3 ± 0.68	S2 にクロストーク	53 ± 1.4

Table 5.5: クロストークレート:中性子ヒット中の各事象の割合(%)



Fig. 5.49: クロストークのないイベント:上から Layer1(電圧印加)のワイヤー W1、ストリップ S1、Layer2(電圧 印加せず)のワイヤー W2、ストリップ S2 のヒットタイミングを表す。横軸が時間(負の方向に時間が進む。)、縦軸がチャンネルを表し、赤印がヒットを表す。W1 と S1 の 1 チャンネルだけにヒットがあり、TGC が正常な 動作をしていることがわかる。



Fig. 5.50: クロストークのあるイベント:大きな信号により W1 の複数のチャンネルにヒットがあり (同層内のクロストーク)、S1 に関してはほぼ全チャンネルに同時にヒットがある (マルチヒット)。また、電圧を印加していない Layer2 にもヒットがあり、Layer1-2 間でのクロストークも起こっていることがわかる。

5.5 TGC 中性子シミュレーション

中性子照射試験の実験結果についての理解を深めるために、Geant4を使用したモンテカルロシミュレーショ ンを行った。Geant4 はプログラミング言語である C++を使用して記述されたシミュレーションソフトである。 Geant4 のパッケージに含まれるプログラミング例の中の N03 を元にコードを改良し、TGC に中性子を入射さ せてデータをとるプログラムを作成した。このプログラムでは、中性子のエネルギーを任意に決めることが出来 る。実際に試験を行った 2.5*MeV*、14*MeV* 以外にも様々なエネルギースペクトルの中性子を入射し、TGC の動 作の内部構造の研究を行った。

5.5.1 シミュレーションの概要とセットアップ

Geant4 では、実際に行われた実験結果に基づいてデータを生成するのだが、Geant4 にはデフォルトではハドロ ンに関する反応は組み込まれていないため、ハドロンの反応に関係するシミュレーションを行う際には、適したモ デルを組み込む必要がある。本シミュレーションには、低エネルギーの中性子の反応を取り扱った*G4NeutronHP* モデルを組み込んだ。*G4NeutronHP* モデルでは、*G4NDL*3.7 というデータベースに基づいてイベントを生成 する。このモデルを *Geant4* の物理現象を司るクラスである *PhysicsList* に組み込むことで、数 *MeV* から十数 *MeV* の中性子に関する反応のシミュレーションを可能にした。

シミュレーションには簡略化した T7 タイプの TGC を組み込んだ。シミュレーションに組み込む検出器は、その幾何学的形状、位置情報とともに、構成物質によって定義する。その構成物質は、原子組成と物質の密度を指定 することで与えられる。その情報を *ExN*03*DetectorConstruction* クラスのメンバを使用して記述することで、 検出器が作成される。セットアップ図を Fig.5.51 に載せる。また、各物質のパラメータを Table5.6 に載せる。こ の TGC の中心に中性子を垂直入射させ、データを取得した。3 章に述べたように本来の TGC はさらに複雑な 構造をしているのだが、中性子が物質と相互作用する反応断面積は $10^{-24}cm^2$ と非常に小さいので、ある程度の 物質量を持った FR4 フレームと充填ガスがそのほとんどどを占めると考えられるため、ワイヤー以外にはこの 2 つのみを組み込んだ。このことは過去に行われている同様のシミュレーションの結果としても示されている [5]。 ガスボリュームは *SensitiveDetector* に指定した。*SensitiveDetector* に指定することで、その検出器内での粒 子の振る舞いを詳しく知ることができる。充填ガスは実験に使用した CO_2 +n-Pentane、 CF_4 +n-Pentaneのガス 比率 55:45、70:30 の計 4 種類のガスを組み込んだ。

シミュレーションでは、様々な情報をデータとして出力させることが出来る。シミュレーションでの粒子の入 射からデータ取得までの流れを述べる。

- 入射させる粒子は、シミュレーション開始時に指定するマクロファイルに書き込むことで決めることができる。今回指定したパラメータは入射粒子(中性子)、入射粒子数(1.0 × 10⁶)、入射粒子のエネルギーである。このマクロファイルを指定してシミュレーションを走らせる。
- 2.1回のシミュレーションは大きく以下の3つに分けられ、それぞれのクラスでデータが保持される。
 - (1) Run:シミュレーションの最初から最後までを指す。*ExN*03*RunAction* クラスが管理する。
 - (2) Event:粒子1発の入射についてのシミュレーションを指す。*ExN03EventAction*クラスが管理する。 *ExN03EventAction*クラスのメンバである *EndOfEventAction*内に *SD*からの情報を記録する記述を入れた。
 - (3) Step:粒子が反応、生成されるたびに生成される。*ExN03SteppingAction*クラスが管理する。各粒子のエネルギー損失、位置、起源となる物質などの情報を持つ。
- 3. 各 *Event*、各 *Step* ごとに保持されたデータを集めることで、粒子の情報や *SensitiveDetector* からの情報 を得ることができる。

今回のシミュレーションでは、

- 1. 中性子と反応し、陽子、原子核を放出した物質
- 2. 中性子によりガス内に放出された粒子の種類
- 3. 中性子によりガス内に放出された粒子がガス内に落としたエネルギー
- 4. 中性子によりガス内に放出された粒子がエネルギーを落とした位置

などの情報を集め、解析し、

- 1. 中性子感度
- 2. TGC を構成する各物質の中性子感度
- 3. 中性子によりガス内に放出された粒子がガス内に落としたエネルギーの分布

4. 中性子によりガス内に放出された粒子がエネルギーを落とした位置の分布

を出した。



Fig. 5.51: シミュレーションでの TGC の構造

物質	FR4	Gas	Wire
厚み、直径 (mm)	5	2.8	0.05
密度 (g/cm^3)	1.7	$32.1 \thicksim 50.8$	19.3
radiation $length(g/cm^2)$	27.05	$36.6 \thicksim 42.0$	6.76
interaction $length(g/cm^2)$	90.2	-	185

Table 5.6: シミュレーションセットアップの各種パラメータ

5.5.2 シミュレーション結果と考察

中性子感度は、TGC に 1.0 × 10⁶ 個の中性子を入射させ、ガス内でのエネルギー損失の総和が0 でないもの を中性子ヒットとみなし、その数をカウントした。結果を実験値とともに Fig.5.52 に載せる。実験値と比較する と、シミュレーション値が実験値を大きく上回っている。2.5*MeV* では 1.5 から 2 倍、14*MeV* では 2 倍弱の値 が出ている。原因としては、

- 1. ガス内でのエネルギー損失の総和は0 でないが、吸着等の効果でワイヤーには届かず、信号を生成しない もの
- 2. 信号は生成するが実験で設定した閾値を超えずヒットとみなされないもの

が挙げられ、これらの点での実験とシミュレーションでの相違が中性子感度の差として表れていることが考えられる。

1. のようなものとして考えられるのが、中性子が FR4 をたたいて出てくる原子核である。エネルギーの低い 原子核は陽子同様、エネルギー損失が大きいためガス内でそのエネルギーを失いすぐに止まってしまう。その場 合、電離された電子は壁の近くに多く分布することになるため、ワイヤーまで届かずガスや壁に再吸着されるか もしれない。このような原子核が多数存在する場合、実験値との差が大きくなる。このことについて調べるため に FR4 フレームから出てきた原子核のみの、ガス内での位置分布を示したものが Fig.5.54 である。横軸が位置、 縦軸がイベント数を表す。これを見ると、壁に吸着されるような原子核は全体の中性子ヒット数の1%に満たな いため、中性子感度に大きな影響を及ぼすとは考られない。

2. について述べると、*Geant4* ではステップが刻まれる際は必ずイオン化が起こっている。イオン化が起こった際、少なくとも数百 *eV* 程度のエネルギー損失があるため、電子が生成されないようなイベントはないと考えられる。したがって、実験では中性子の信号をなるべくカットしないように閾値はできる限り低くしていることからも、閾値を超えないような信号はないと考えられる。残る可能性として、実験データからの中性子感度の導出の際に計算し、使用した TGC への中性子入射数、中性子ヒット数に含まれる誤差がある。これらの値に含まれる誤差を考えた場合、実験値とシミュレーション値の差が小さくなる可能性がある。この点については今後追求していく。

次に、TGC を構成する各物質についての中性子感度の図を Fig.5.53 に載せる。2.5MeV 以下の中性子エネル ギーでは主にガス分子が、14MeV 付近では主に FR4 が中性子と反応して信号を生成していることがわかる。ガ スの中性子感度の差は 2.5MeV と 14MeV でごくわずかであるが、FR4 については 14MeV での中性子感度が 2.5MeV の中性子感度の約5倍と大きく変化している。次に、中性子によりガス内に放出された粒子が落とすエ ネルギー分布を Fig.5.55 に載せる。全てのガスにおいて 14MeV のピークは 2.5MeV のピークのおよそ 10分の 1 であり、これは、Fig.4.11 を良く表しており、実験とも一致している。また、Fig.5.55の 0.5MeV 以上の分布を 拡大したものを Fig.5.56 に載せる。この図から、14MeV の方が 2.5MeV に比べ、粒子が落とすエネルギー分布 の最大値が大きいことが分かる。これも実験と一致している。実験とシミュレーションとの違いに関して、実験で は中性子による出力電荷量分布の中性子ピークの位置が $CO_2 & CF_4$ で大きな差があったのに対し、シミュレー ションではその差が殆どない。この原因として、このシミュレーションでは出力電荷量ではなく、エネルギー損 失の大きさの分布を出しただけであるからだと考えられる。実際に観測されたパルス高と関係付けるには、エネ ルギー損失だけでなく、ガス増幅の過程やドリフト中の電子の分子による吸着を組み込む必要があるのだが、こ れらについてははっきりと解明されておらず、シミュレーションに組み込むことが出来ない。実際には CO_2 に比 べ電気陰性度が非常に高いフッ素を含む CF_4 の方が良く電子を吸着し、信号が小さくなると考えられる。また、 シミュレーションにおいても、n-Pentaneの比率による出力電荷量分布の差は見られなかった。



Fig. 5.52: 中性子感度:ガス ID は 1 が CO_2 +n-Pentane(55:45)、2 が CO_2 +n-Pentane(70:30)、3 が CF_4 +n-Pentane(55:45)、4 が CF_4 +n-Pentane(70:30)



Fig. 5.53: TGC を構成する物質の中性子感度:シミュレーションを行った中性子エネルギーは1MeV、2.5MeV、4MeV、7MeV、10MeV、14MeV、17MeV



Fig. 5.54: FR4 起源の原子核の分布



Fig. 5.55: TGC に落とされたエネルギー分布



Fig. 5.56: Fig.5.55 の 0.5*MeV* 以上の分布の拡大図

6 まとめと今後

6.1 まとめ

2007 年よりスイスのジュネーブにある CERN で開始予定の ATLAS 実験で、ミューオントリガーチェンバー として TGC が使用される。ATLAS 検出器への TGC のインストールは着々と進められており、ATLAS 実験で TGC はしっかりと動作することが期待される。

シミュレーションにより、ATLAS 実験での TGC 設置位置での γ 線、中性子バックグラウンドは数 kHz から十数 kHz と見積もられている。この環境下で TGC は安定に動作しなければならない。 γ 線バックグラウンドに対する TGC の動作は既に確認されており、正常に動作することが保障されている。今回の実験では、日本原子力研究所 FNS の中性子源を利用し、ATLAS 実験での中性子バックグラウンドに対する TGC の動作の確認、動作特性の研究を目的として、TGC への中性子照射試験を行った。同時に、ATLAS 実験で使用される CO_2 +n-Pentane に加え、放射線耐性に実績のある CF_4 を混入した CF_4 +n-Pentane をチェンバーガスとして流入し、TGC が放射線環境下でより安定して動作するための代替ガスの研究も行った。また、 $CO_2(CF_4)$:n-Pentane=55:45、70:30 と混合比を変えて測定し、n-Pentane の効果についての研究も行った。

中性子照射試験では TGC に、2.5*MeV*、14*MeV* の単色中性子を入射し、

- 1. 中性子感度
- 2. 中性子入射時の出力電荷量
- 3. 中性子入射時の放電レート
- 4. クロストークイベント発生レート

を測定した。

中性子感度は中性子入射数の、2.5*MeV* の中性子に対して 0.018 %から 0.024 %、14*MeV* の中性子に対して 0.083 %から 0.10 %という結果が出ており、ATLAS 実験での TGC の中性子ヒットレートは数 *Hz* 程度であると 予想される。

出力電荷量の測定では、中性子エネルギー、TGC への印加電圧、ベースガス (CO_2 、 CF_4)、n-Pentane 比率の 違いによる出力電荷量分布の特徴を知ることができた。結果として、中性子エネルギーが大きくなるほど出力電 荷量は広く分布し、大きな信号を生成するようになる。また、TGC への印加電圧が高くなるほど、中性子のピー クは印加電圧にほぼ比例して出力電荷量の大きくなる方向にシフトしていき、このことは特に CO_2 ベースのガ スで顕著に表れた。 CO_2 ベースのガスでは、2.5MeVの中性子と14MeVの中性子でピーク位置の大きさ、推移 の仕方に変化があったが、 CF_4 ではその変化はほとんど見られなかった。 CF_4 ベースのガスでは、出力電荷量や 電圧によるピーク位置の変化が CO_2 ベースのガスに比べて小さいことから、中性子による信号がサチュレート していると考えられる。よって、中性子による大きな信号が出にくくなっている。ATLAS 実験での中性子によ る TGC への悪影響として考えられる放電の頻発やそれによる早期劣化、クロストークは全て中性子による大き な信号が原因であるため、 CF_4 をチェンバーガスに使用することでその大きな信号が抑えられ、中性子の悪影響 が軽減されることが期待される。

放電は、ATLAS 実験での TGC の動作電圧である 2.9kV 付近では観測されず、また、電源をトリップさせるほどの大きな放電 (リークカレント > $10\mu A$) も観測されなかった。よって、ATLAS 実験で中性子の信号による放電の影響は、ほとんどないと考えてよい。

今回の実験で、クロストークイベントが観測された。クロストークイベントの測定では、大型 TGC の片面にの

み電圧を印加し、読出しは全チャンネルから行った。電圧を印加した面のワイヤー、ストリップをW1、S1、他 方をW2、S2とすると、TGCで中性子ヒットが観測された場合の0.24%でW1に、37%でS1に、6.3%でW2 に、53%でS2にクロストークあるいはマルチヒット信号が生成される。とくにストリップではクロストークの ほとんどがマルチヒットであった。

中性子照射試験の結果の評価、内部構造の理解のため、*Geant4*を用いたシミュレーションを行った。T7タイプのTGCを作成し、その中心に中性子を垂直入射させて様々なデータを取り出した。取り出したデータは以下である。

1. 中性子感度

- 2. TGC 構成物質それぞれの中性子感度
- 3 ガスボリューム内でのエネルギー損失
- 4. ガスボリューム内での粒子の位置情報

以下にそれぞれについての計算結果を述べる。

中性子感度は、2.5*MeV*の中性子に対して0.032%から0.047%、14*MeV*の中性子に対して0.15%程度という結果が出ており、実験値と比較して大きい。シミュレーションの正当性については、過去に行われた同様のシミュレーションの結果 [5]とよく一致しているため、問題ないと思われる。原因のひとつとして、原子核または原子核により放出された電子がFR4、ガス分子によって再吸着され、信号を生成しないことが考えられる。原子核はエネルギー損失が大きく、ガス内ですぐに止まり、FR4に吸着される可能性が高い。*Geant4*には吸着は組み込まれていないため、この効果が大きければ中性子感度に影響すると考えた。このことを調べるために、ガスボリューム内でのイオンの位置分布情報を取り出し解析した。その結果、特にFR4付近に目だった粒子の集まりはなく、中性子ヒットに対して1%にも満たないものであったため、中性子感度に大きな影響を及ぼしているとは考えられない。他の原因として、実験での中性子ヒットの導出の過程で生じる20%前後の誤差が考えられるが、この点はまだ確かではなく、今後追求していく必要がある。

中性子のエネルギーによる TGC 構成物質の中性子との反応断面積の変化を調べるため、今回のシミュレーションに組み込んだ FR4 とガスについての中性子感度を、中性子エネルギーを 1*MeV* から 17*MeV* に変えて入射して測定した。2*MeV* 以下の中性子に対しては主にガスが中性子と反応して信号を生成し、FR4 はほとんど反応しないが、2*MeV* 以上では中性子の FR4 に対する反応断面積が徐々に大きくなり、14*MeV* 付近では主に FR4 が中性子と反応して信号を生成していることがわかった。

実験での出力電荷量分布を評価するため、ガスボリューム内でのエネルギー損失の分布を出した。実験結果とし て得られた分布との相違点としては、ベースガスによる違いがほとんど表れなかった点が上げられる。原因はお そらく、シミュレーションにイオンの吸着が組み込まれていないためであると考えられる。ガス分子や TGC の 素材によるイオンの吸着については解明されておらず、シミュレーションに組み込むことができない。中性子の ピークが全ガスで 2.5*MeV* の中性子のほうが大きく出ている点、14*MeV* の方が大きなエネルギー損失を起こし ている点では、実験とよく一致しているといえる。

6.2 今後の予定

中性子照射試験で、TGC に中性子ヒットがあった場合にクロストークヒット、マルチヒットが起こることが分 かった。TGC は ATLAS 実験でミューオンのトリガーチェンバーとして安定に動作することが求められており、 クロストークヒットやマルチヒットによる偽トリガーの影響を知っておかなければならない。これについては、 単に手計算で求めるだけでなく、ATLAS 検出器全体を組み込んだシミュレーションを用いてその影響を確認す ることも考えている。実験値とシミュレーションでの中性子感度の違いについては、TGC への中性子ヒットの導 出方法等についての改良の余地がないか検討し、その原因について追求していく。

現在 TGC は、CERN で最終チェックが行われ、1/12 フレームへと取り付けられている。今後、2007年の実験開始に向けて、TGC のインストール作業に参加し、2006年からスタートされる予定のテストビームを使って TGC の解析を行い、物理解析へと進んでいく予定である。

本研究を行うにあたり、その機会を与えて頂くとともに適切なご指導並びに助言を頂いた武田廣教授^a、野崎 光昭教授^a、蔵重久弥助教授^a、川越清以助教授^a、本間康浩助教授^bに深く感謝いたします。また、本研究に参 加し、惜しみない協力と適切な助言を頂いた岩崎博行教授^c、金子純一助教授^e、越智敦彦助手^a、田中秀治助手 ^cに深く感謝致します。そして、本研究を行う場所を提供して頂くとともに数々の助言を頂き、様々な面で研究 の補助をしていただいた落合健太郎氏^f、中尾誠氏^f、その他日本原子力研究所FNS 職員の皆様に深く感謝致し ます。本研究を進めるにあたり、適切な助言を頂き、研究への理解を助けて頂いた近藤敬比古教授^c、坂本宏教授 ^g、佐々木修助教授^c、福永力助教授^h、池野正弘氏^c、他日本アトラスグループの皆様に深く感謝致します。本研 究を共に行い議論し、数々の助言を頂いき、支えていただいた大下英敏氏^dに深く感謝致します。また、研究生 活を通して議論し、適切な助言を頂いた杉本拓也氏^a、緒方岳氏^a、大町千尋氏^a、田村勇樹氏^a、永曽有亮氏^a、 他研究室の皆様に深く感謝致します。上記の方々の協力があったからこそ、本研究を成功させることができまし た。最後に、全ての方々に、心から感謝申し上げます。

所属:

神戸大学 自然科学研究科^a 神戸大学 工学部^b 高エネルギー加速器研究機構 (KEK)^c 信州大学 工学系研究科^d 北海道大学 工学研究科^e 日本原子力研究所 FNS^f 東京大学素粒子物理国際研究センター (ICEPP)^g 東京都立大学 理学研究科^h

Figure List

1.2 中性子線パックグラウンド Flux のシミュレーション 2 2.1 LHC 加速器 [7] 4 2.2 CMS[9] 5 2.3 Allee[9] 5 2.4 LHC-B[9] 5 2.4 LHC-B[9] 5 3.1 Higgs たの代表的な生成過程:(a)gluon-gluon 融合 (gluon fusion), (b)W/ZZ融合 (Vector Boson Fusion), (c)tift 生成過程:(a)gluon-gluon 融合 (gluon fusion), (b)W/ZZ融合 (Vector Boson Fusion), (c)tift 生成過程:(a)gluon-gluon 融合 (gluon fusion), (b)W/ZZ 融合 (Vector Boson Fusion), (c)tift 生成過程:(a)gluon-gluon 融合 (gluon fusion), (b)W/ZZ 融合 (Vector Boson Fusion), (c)tift 生成過程:(a)gluon-gluon 融合 (gluon fusion), (b)W/ZZ 融合 (Vector Boson Fusion), (c)tift 生成過程:(a)gluon-gluon 融合 (gluon fusion), (b)W/ZZ 融合 (Vector Boson Fusion), (c)tift 生成過程:(a)gluon-gluon 融合 (gluon fusion), (b)W/ZZ 融合 (Vector Boson Fusion), (c)tift 生成過程:(a)gluon-gluon 融合 (gluon fusion), (b)W/ZZ 融合 (Vector Boson Fusion), (c)tift 生成過程:(a)gluon-gluon 融合 (gluon fusion), (b)W/Z 起子 (W/Z associate production) 3.1 Higgs 粒子の分成比と質量の関係 8 3.3 Higgs 粒子の分成比と質量の関係 8 3.4 ATLAS Detector [7] 12 3.5 ATLAS Detector [7] 12 4.8 超伝報 (gluon gluon lost) Flor (Ford) (gluon gluon lost) Flor (Ford) (gluon gluon lost) Flor (Ford) (gluon lost) 13 3.10 粒子の透見他の [1] 16 11 16 3.12 Lof (Ford) A Comber [1] 16	1.1	γ 線バックグラウンド Flux のシミュレーション	2
2.1 LHC 加速器 [7] 4 2.2 CMS[9] 5 2.3 Alice[9] 5 2.4 LHC-B[9] 5 3.1 Higgs ±dx00(\nothermolectric the	1.2	中性子線バックグラウンド Flux のシミュレーション	2
2. CMS[9] 5 2.3 Alice[9] 5 2.4 LHC-B[9] 5 3.1 Higgs 生成の代表的な生成過程:(a) gluon-gluon 融合 (gluonfusion), (b) WW/ZZ 融合 (Vector Boson Fusion), (c) UH 生成過程 (UH production), (d) W/Z 粒子随伴生成 (W/Z associate production) 7 3.2 Higgs 粒子の生成断面積 8 3.3 Higgs 粒子の生成断面積 8 3.4 ATLAS Detector [7] 12 3.6 内部飛艇検出器 [1] 13 3.7 カロリーメータ [1] 14 4.8 起伝導空芯トロイドマグネットの配置 [1] 13 3.7 カロリーメータ [1] 14 4.8 超伝導空芯トロイドマグネットの配置 [1] 15 3.9 エンドキャップトロイドの中央 (z=1050cm) におけるトロイダル磁場 (磁力線) [1] 15 3.10 粒子の透過性の違い 16 3.11 ミューオン検出器 [1] 16 3.12 Monitored Drift Tube [1] 17 3.13 Cathode Strip Chamber [1] 17 3.14 Resistive Plate Chamber [1] 19 3.15 Thin Gap Chamber [1] 20 3.16 ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11] 21 3.17 エンドキャップミューオントリガー[1] 22 3.18 M1 ステーションの TGC の配置 [1] 23 3.20 Doublet / Triptet 断面図 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 <td< td=""><td>2.1</td><td>LHC 加速器 [7]</td><td>4</td></td<>	2.1	LHC 加速器 [7]	4
2.3 Alice(9) 5 2.4 LHC-B[9] 5 2.4 LHC-B[9] 5 3.1 Higgs 生成の代表的な生成過程:(i)ghuon-ghuon 融合 (ghuon fusion), (b)WW/ZZ 融合 (Vector Boson Fusion), (c)tiH 生成過程 (tiH production), (d)W/Z 粒子随伴生成 (W/Z associate production) 7 3.2 Higgs 粒子の分抜比と質量の関係 8 3.3 Higgs 粒子の分抜比と質量の関係 8 3.4 ATLAS OHiggs 発見能力 [10] 9 3.5 ATLAS Detector [7] 12 2.6 内部飛跡検出器 [1] 13 3.7 カロリーメータ [1] 14 3.8 超伝導空芯トロイドマグネットの配置 [1] 13 3.7 カロリーメータ [1] 14 3.8 超伝導空芯トロイドマグネットの配置 [1] 15 3.9 エンドキャップトロイドの中央 (z=1050cm) におけるトロイダル磁場 (磁力線) [1] 15 3.10 粒子の透過性の違い 16 3.11 ミューオン検出器 [1] 16 3.12 Monitored Drift Tube [1] 17 3.13 Thin Gap Chamber [1] 19 3.14 Resistive Plate Chamber [1] 20 3.15 ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11] 21 3.17 エンドキャップミューオントリガー [1] 22 3.18 MI ステーションの TGC の配置 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21	2.2	CMS[9]	5
2.4 LHC-B[9] 5 3.1 Higgs 生成の代表的な生成過程:(a)gluon-gluon 融合 (gluon fusion), (b)WW/ZZ 融合 (Vector Boson Fusion), (c)/ <i>H</i> 生成過程 (<i>H</i> production), (d)W/Z 粒子随伴生成 (W/Z associate production) 7 Higgs 粒子の全成断面積 8 3.3 Higgs 粒子の分岐比と質量の関係 8 3.4 ATLAS O Higgs 発見能力 [10] 9 3.5 ATLAS D Higgs 死見能力 [10] 12 3.6 内部飛跡検出器 [1] 13 3.7 カロリーメータ [1] 14 3.8 超伝導空芯トロイドマグネットの配置 [1] 15 3.9 エンドキャップトロイドの中央 (z=1050cm) におけるトロイダル磁場 (磁力線) [1] 15 3.10 粒子の透過性の違い 16 3.11 シューオン検出器 [1] 16 3.12 Monitored Drift Tube [1] 16 3.13 Cathode Strip Chamber [1] 17 3.14 Resistive Plate Chamber [1] 19 3.15 Thin Gap Chamber [1] 20 3.16 ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11] 21 3.17 エンドキャップミューオントリガー [1] 22 3.18 MI ステーションの TGC の配置 [1] 23 3.19 M3 ステーションの TGC の配置 [1] 23 3.20 Poublet / Triptet 断面置 [1]	2.3	Alice[9]	5
3.1 Higgs 生成の代表的な生成過程:(a) gluon-gluon 融合 (gluon fusion), (b) WW/ZZ融合 (Vector Boson Fusion), (c) tiH 生成過程 (tiH production), (d) W/Z 粒子随伴生成 (W/Z associate production) 7 3.2 Higgs 粒子の生成断面積 8 3.3 Higgs 粒子の生成断面積 8 3.4 ATLAS O Higgs 発見能力 [10] 9 3.5 ATLAS Detector [7] 12 3.6 内部飛跡検出器 [1] 13 3.7 カロリーメータ [1] 14 3.8 超伝導空芯トロイドマグネットの配置 [1] 15 3.9 エンドキャップトロイドの中央 (z=1050cm) におけるトロイダル磁場 (磁力線) [1] 15 3.10 粒子の透過性の違い 16 3.11 ミューオン検出器 [1] 16 3.12 Monitored Drift Tube [1] 17 3.13 Cathode Strip Chamber [1] 18 3.14 Resistive Plate Chamber [1] 20 3.15 Thin Gap Chamber [1] 21 3.16 ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11] 21 3.17 オンドキャッブミューオントリガー [1] 22 3.18 M1 ステーションの TGC の配置 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] </td <td>2.4</td> <td>LHC-B[9]</td> <td>5</td>	2.4	LHC-B[9]	5
3.1 Higgs 生成の代表的な生成過程:(a)gluon-gluon 融合 (gluon fusion), (b)WW/ZZ融合 (Vector Boson Fusion), (c)ifit 生成過程 (ifit production), (d)W/Z 粒子随伴生成 (W/Z associate production) 7 3.2 Higgs 粒子の生成断面積 8 3.3 Higgs 粒子の分岐比と質量の関係 8 3.4 ATLAS 0 Higgs 発見能力 [10] 9 3.5 ATLAS Detector [7] 12 3.6 内部飛蹄検出器 [1] 13 3.7 カロリーメータ [1] 14 3.8 超伝導空芯トロイドマグネットの配置 [1] 15 3.9 エンドキャップトロイドの中央 (z=1050cm) におけるトロイダル磁場 (磁力線) [1] 15 3.10 粒子の透過性の違い 16 3.11 ミューオン検出器 [1] 16 3.12 Monitored Drift Tube [1] 16 3.13 Cathode Strip Chamber [1] 17 3.14 Resistive Plate Chamber [1] 19 3.15 Thin Gap Chamber [1] 21 3.16 ATLAS の見の・リガーシステムのスキーム [11] 21 3.17 エンドキャップミューオントリガー [1] 22 3.18 M1 ステーションの TGC の配置 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11			
Fusion), (c)tH 生成過程(tH production), (d)W/Z 粒子随伴生成(W/Z associate production) 7 3.2 Higgs 粒子の生成断面積 8 3.3 Higgs 粒子の分岐比と質量の関係 8 3.4 ATLAS O Higgs 発見能力[10] 9 3.5 ATLAS D Higgs 発見能力[10] 9 3.6 ATLAS Detector [7] 12 3.7 カロリーメータ[1] 14 3.8 超伝導空芯トロイドマグネットの配置 [1] 13 3.7 カロリーメータ[1] 14 3.8 超伝導空芯トロイドマグネットの配置 [1] 15 3.9 エンドキャップトロイドの中央(z=1050cm)におけるトロイダル磁場(磁力線)[1] 15 3.10 粒子の透過性の違い 16 3.11 ミューオン検出器 [1] 16 3.12 Monitored Drift Tube [1] 17 3.13 Cathode Strip Chamber [1] 19 3.14 Resistive Plate Chamber [1] 20 3.15 ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11] 21 3.16 ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11] 22 3.17 エンドキャップミューオントリガー [1] 22 3.18 M1 ステーションの TGC の配置 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] </td <td>3.1</td> <td>Higgs 生成の代表的な生成過程:(a)gluon-gluon 融合 (gluon fusion)、(b)WW/ZZ 融合 (Vector Boson</td> <td></td>	3.1	Higgs 生成の代表的な生成過程:(a)gluon-gluon 融合 (gluon fusion)、(b)WW/ZZ 融合 (Vector Boson	
32 Higgs 粒子の今岐比と質量の関係 8 33 Higgs 粒子の今岐比と質量の関係 8 34 ATLAS D Higgs 発見能力 [10] 9 35 ATLAS Detector [7] 12 36 ATLAS Detector [7] 13 37 カロリーメータ [1] 13 37 カロリーメータ [1] 14 38 超伝導空芯トロイドマグネットの配置 [1] 15 39 エンドキャップトロイドの中央 (z=1050cm) におけるトロイダル磁場 (磁力線) [1] 15 310 粒子の透過性の違い 16 311 ミューオン検出器 [1] 16 312 Monitored Drift Tube [1] 17 313 Cathode Strip Chamber [1] 18 314 Resistive Plate Chamber [1] 19 315 Thin Gap Chamber [1] 20 316 ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11] 21 317 エンドキャッブミューオントリガー [1] 22 318 M1 ステーションの TGC の配置 [1] 22 320 Doublet / Triplet 断面図 [1] 23 321 トリガースキーム [11] 23 321 トリガースキーム [11] 23 321 トリガースキーム [11] 23 321 <td></td> <td>Fusion)、(c)$t\bar{t}H$ 生成過程 ($t\bar{t}H$ production)、(d)W/Z 粒子随伴生成 (W/Z associate production)</td> <td>7</td>		Fusion)、(c) $t\bar{t}H$ 生成過程 ($t\bar{t}H$ production)、(d)W/Z 粒子随伴生成 (W/Z associate production)	7
3.3 Higgs 粒子の分岐比と質量の関係 8 3.4 ATLAS の Higgs 発見能力 [10] 9 3.5 ATLAS Detector [7] 12 3.6 内部飛跡検出器 [1] 13 3.7 カロリーメータ [1] 14 3.8 超伝導空芯トロイドマグネットの配置 [1] 15 3.9 エンドキャップトロイドの中央 (z=1050cm) におけるトロイダル磁場 (磁力線) [1] 15 3.10 粒子の透過性の違い 16 3.11 ミューオン検出器 [1] 16 3.12 エンドキャップトロイドの中央 (z=1050cm) におけるトロイダル磁場 (磁力線) [1] 15 3.10 粒子の透過性の違い 16 3.11 ミューオン検出器 [1] 17 3.12 Monitored Drift Tube [1] 16 3.13 Cathode Strip Chamber [1] 18 3.14 Resistive Plate Chamber [1] 19 3.15 Thin Gap Chamber [1] 20 3.16 ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11] 21 3.17 エンドキャップミューオントリガー [1] 22 3.18 M1 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.20 Doublet / Triplet 断面図 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] <td< td=""><td>3.2</td><td>Higgs 粒子の生成断面積</td><td>8</td></td<>	3.2	Higgs 粒子の生成断面積	8
3.4 ATLAS D Higgs 発見能力 [10] 9 3.5 ATLAS Detector [7] 12 3.6 内部飛跡検出器 [1] 13 3.7 カロリーメータ [1] 14 3.8 超伝導空芯トロイドマグネットの配置 [1] 15 3.9 エンドキャップトロイドの中央 (z=1050cm) におけるトロイグル磁場 (磁力線) [1] 15 3.10 粒子の透過性の違い 16 3.11 ミューオン検出器 [1] 16 3.12 Monitored Drift Tube [1] 17 3.13 Cathode Strip Chamber [1] 18 3.14 Resistive Plate Chamber [1] 19 3.15 Thin Gap Chamber [1] 19 3.16 ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11] 20 3.17 エンドキャップミューオントリガー [1] 21 3.17 エンドキャップミューオントリガー [1] 22 3.18 M1 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.20 Doublet / Triplet 断面図 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 24 <t< td=""><td>3.3</td><td>Higgs 粒子の分岐比と質量の関係</td><td>8</td></t<>	3.3	Higgs 粒子の分岐比と質量の関係	8
3.5 ATLAS Detector [7] 12 3.6 内部飛跡検出器 [1] 13 3.7 カロリーメータ [1] 14 3.8 超伝導空芯トロイドマグネットの配置 [1] 15 3.9 エンドキャップトロイドの中央 (z=1050cm) におけるトロイダル磁場 (磁力線) [1] 15 3.10 粒子の透過性の違い 16 3.11 ミューオン検出器 [1] 17 3.12 Monitored Drift Tube [1] 17 3.13 Cathode Strip Chamber [1] 18 3.14 Resistive Plate Chamber [1] 19 3.15 Thin Gap Chamber [1] 20 3.16 ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11] 21 3.17 エンドキャップミューオントリガー [1] 22 3.18 M1 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.19 M3 ステーションの TGC の配置 [1] 23 20 Doublet / Triplet 断面図 [1] 23 3.1 Pグンゼント型電子なだれ 24 4.2 各動作モードにおける印加電圧と出力パルス波高の関係 26 4.3 n-Pentane の紫外線吸収断面積 27 4.4 2 合動作モードにおける印加電圧と出力パルス波高の関係 27 4.5 TGC の構造 (評面図) [1] 27 4.6 Wire 方向の読みのし部分の構造 [1]	3.4	ATLAS の Higgs 発見能力 [10]	9
3.6 内部飛跡検出器 [1] 13 3.7 カロリーメータ [1] 14 3.8 超伝導空芯トロイドマグネットの配置 [1] 15 3.9 エンドキャップトロイドの中央 (z=1050em) におけるトロイグル磁場 (磁力線) [1] 15 3.10 粒子の透過性の違い 16 3.11 ミューオン検出器 [1] 16 3.12 Monitored Drift Tube [1] 17 3.13 Cathode Strip Chamber [1] 17 3.14 Resistive Plate Chamber [1] 19 3.15 Thin Gap Chamber [1] 20 3.16 ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11] 21 3.17 エンドキャップミューオントリガー [1] 22 3.18 MI ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.19 M3 ステーションの TGC の配置 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 4.1 タウンゼント型電子なだれ 24 4.2 各動作モードにおける印加電圧と出力パルス波高の関係 26 4.3 n-Pentane の紫外線吸収断面積 26 4.4 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.5 TGC の構造 (平面図) 27 4.6 Wire 方向の読み出し部分の構造 [1] 28 <	3.5	ATLAS Detector [7]	12
3.7 カロリーメータ [1] 14 3.8 超伝導空芯トロイドマグネットの配置 [1] 15 3.9 エンドキャップトロイドの中央 (z=1050cm) におけるトロイグル磁場 (磁力線) [1] 15 3.10 粒子の透過性の違い 16 3.11 ミューオン検出器 [1] 16 3.12 Monitored Drift Tube [1] 17 3.13 Cathode Strip Chamber [1] 17 3.14 Resistive Plate Chamber [1] 19 3.15 Thin Gap Chamber [1] 20 3.16 ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11] 21 3.17 エンドキャップミューオントリガー [1] 22 3.18 M1 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.19 M3 ステーションの TGC の配置 [1] 23 3.20 Doublet / Triplet 断面図 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 4.1 タウンゼント型電子なだれ 24 4.2 各動作モードにおける印加電圧と出力パルス波高の関係 26 4.3 ホ-Pentane の紫外線吸収断面積 26 4.4 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.5 TGC の構造 (正面図) 27 4.6 Wire 方向の読み出し部分の構造 [1] 28 4.7 TGC の構造 (正面図) 27	3.6	内部飛跡検出器 [1]	13
3.8 超伝導空芯トロイドマグネットの配置 [1] 15 3.9 エンドキャップトロイドの中央 (z=1050cm) におけるトロイダル磁場 (磁力線) [1] 15 3.10 粒子の透過性の違い 16 3.11 ミューオン検出器 [1] 16 3.12 Monitored Drift Tube [1] 17 3.13 Cathode Strip Chamber [1] 18 3.14 Resistive Plate Chamber [1] 19 3.15 Thin Gap Chamber [1] 20 3.16 ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11] 21 3.17 エンドキャップミューオントリガー [1] 22 3.18 MI ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.19 M3 ステーションの TGC の配置 [1] 23 3.20 Doublet / Triplet 断面図 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] 24 4.2 各動作モードにおける印加電圧と出力パルス波高の関係 26 4.3 n-Pentane の紫外線吸収断面積 26 4.4 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.5 TGC の構造 (平面図) 27 4.6 Wire 方向の読み出し部分の構造 [1] 28 4.7 TGC の電場 (左)・電位 (右) 構造のシミュレーション [16] 28 4.8 ASD ASIC 回路図 29 4.9 オシロスコープで見た 0.1pC から 0.5pC までの入力に対するプリアンプの外部出力 30	3.7	カロリーメータ [1]	14
3.9 エンドキャップトロイドの中央 (z=1050cm) におけるトロイダル磁場 (磁力線) [1] 15 3.10 粒子の透過性の違い 16 3.11 ミューオン検出器 [1] 16 3.12 Monitored Drift Tube [1] 17 3.13 Cathode Strip Chamber [1] 18 3.14 Resistive Plate Chamber [1] 19 3.15 Thin Gap Chamber [1] 20 3.16 ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11] 21 3.17 エンドキャップミューオントリガー [1] 22 3.18 M1 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.19 M3 ステーションの TGC の配置 [1] 23 3.20 Doublet / Triplet 断面図 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] 24 4.2 各動作モードにおける印加電圧と出力パルス波高の関係 26 4.3 n-Pentane の紫外線吸収断面積 26 4.4 石GC の構造 (断面図) [1] 27 74 TGC の構造 (断面図) [1] 27 75 TGC の電場 (た)・電位 (右) 構造のシミュレーション 27 76 Wire 方向の読み出し部分の構造 [1]	3.8	超伝導空芯トロイドマグネットの配置 [1]	15
3.10 粒子の透過性の違い 16 3.11 ミューオン検出器 [1] 16 3.12 Monitored Drift Tube [1] 17 3.13 Cathode Strip Chamber [1] 18 3.14 Resistive Plate Chamber [1] 19 3.15 Thin Gap Chamber [1] 20 3.16 ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11] 21 3.17 エンドキャップミューオントリガー [1] 22 3.18 M1 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.19 M3 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.20 Doublet / Triplet 断面図 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 4.1 タウンゼント型電子なだれ 24 4.2 各動作モードにおける印加電圧と出力パルス波高の関係 26 4.3 n-Pentane の紫外線吸収断面積 27 74 TGC の構造 (断面図) [1] 27 75 TGC の構造 (断面図) [1] 27 74 Wire 方向の読み出し部分の構造 [1] 28 74 Wire 方向の読み出し部分の構造 (1] 28 7	3.9	エンドキャップトロイドの中央 (z=1050cm) におけるトロイダル磁場 (磁力線) [1]	15
3.11 ミューオン検出器 [1] 16 3.12 Monitored Drift Tube [1] 17 3.13 Cathode Strip Chamber [1] 18 3.14 Resistive Plate Chamber [1] 19 3.15 Thin Gap Chamber [1] 20 3.16 ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11] 21 3.17 エンドキャップミューオントリガー [1] 22 3.18 M1 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.19 M3 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.20 Doublet / Triplet 断面図 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 4.1 タウンゼント型電子なだれ 24 4.2 各動作モードにおける印加電圧と出力パルス波高の関係 26 4.3 n-Pentane の紫外線吸収断面積 26 4.4 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.5 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.6 Wire 方向の読み出し部分の構造 [1] 28 4.7 TGC の電場 (左)・電位 (右) 構造のシミュレーション [16] 28 4.8 ASD ASIC 回路図 29 4.9 オシロスコープで見た 0.1pC から 0.5pC までの入力に対するプリアンプの外部出力 30	3.10	粒子の透過性の違い	16
3.12 Monitored Drift Tube [1] 17 3.13 Cathode Strip Chamber [1] 18 3.14 Resistive Plate Chamber [1] 19 3.15 Thin Gap Chamber [1] 20 3.16 ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11] 21 3.17 エンドキャップミューオントリガー [1] 22 3.18 M1 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.19 M3 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.20 Doublet / Triplet 断面図 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 4.1 タウンゼント型電子なだれ 24 4.2 各動作モードにおける印加電圧と出力パルス波高の関係 26 4.3 n-Pentane の紫外線吸収断面積 27 4.5 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.6 Wire 方向の読み出し部分の構造 [1] 28 4.7 TGC の電場 (左)・電位 (右) 構造のシミュレーション [16] 28 4.8 ASD ASIC 回路図 29 4.9 オシロスコープで見た 0.1pC から 0.5pC までの入力に対するプリアンプの外部出力 30	3.11	ミューオン検出器 [1]	16
3.13 Cathode Strip Chamber [1] 18 3.14 Resistive Plate Chamber [1] 19 3.15 Thin Gap Chamber [1] 20 3.16 ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11] 21 3.17 エンドキャップミューオントリガー [1] 22 3.18 M1 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.19 M3 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.20 Doublet / Triplet 断面図 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 4.1 タウンゼント型電子なだれ 24 4.2 各動作モードにおける印加電圧と出力パルス波高の関係 26 4.3 n-Pentane の紫外線吸収断面積 26 4.4 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.5 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.6 Wire 方向の読み出し部分の構造 [1] 28 4.7 TGC の電場 (左)・電位 (右) 構造のシミュレーション [16] 28 4.8 ASD ASIC 回路図 29 4.9 オシロスコープ電見た 0.1pC から 0.5pC までの入力に対するプリアンプの外部出力 30 4.10 ASD Parend 20	3.12	Monitored Drift Tube [1]	17
3.14 Resistive Plate Chamber [1] 19 3.15 Thin Gap Chamber [1] 20 3.16 ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11] 21 3.17 エンドキャップミューオントリガー [1] 22 3.18 M1 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.19 M3 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.20 Doublet / Triplet 断面図 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 4.1 タウンゼント型電子なだれ 24 4.2 各動作モードにおける印加電圧と出力パルス波高の関係 26 4.3 n-Pentane の紫外線吸収断面積 26 4.4 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.5 TGC の構造 (平面図) 27 4.6 Wire 方向の読み出し部分の構造 [1] 28 4.7 TGC の電場 (左)・電位 (右) 構造のシミュレーション [16] 28 4.8 ASD ASIC 回路図 29 4.9 オシロスコープで見た 0.1pC から 0.5pC までの入力に対するプリアンプの外部出力 30	3.13	Cathode Strip Chamber [1]	18
3.15 Thin Gap Chamber [1] 20 3.16 ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11] 21 3.17 エンドキャップミューオントリガー [1] 22 3.18 M1 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.19 M3 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.20 Doublet / Triplet 断面図 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 4.1 タウンゼント型電子なだれ 24 4.2 各動作モードにおける印加電圧と出力パルス波高の関係 26 4.3 n-Pentane の紫外線吸収断面積 26 4.4 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.5 TGC の構造 (画図) 27 4.6 Wire 方向の読み出し部分の構造 [1] 28 4.7 TGC の電場 (左)・電位 (右) 構造のシミュレーション [16] 28 4.8 ASD ASIC 回路図 29 4.9 オシロスコープで見た 0.1pC から 0.5pC までの入力に対するプリアンプの外部出力 30 4.10 ASD Pared 20	3.14	Resistive Plate Chamber [1]	19
3.16 ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11] 21 3.17 エンドキャップミューオントリガー [1] 22 3.18 M1 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.19 M3 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.20 Doublet / Triplet 断面図 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 4.1 タウンゼント型電子なだれ 24 4.2 各動作モードにおける印加電圧と出力パルス波高の関係 26 4.3 n-Pentane の紫外線吸収断面積 26 4.4 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.5 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.6 Wire 方向の読み出し部分の構造 [1] 28 4.7 TGC の電場 (左)・電位 (右) 構造のシミュレーション [16] 28 4.8 ASD ASIC 回路図 29 4.9 オシロスコープで見た 0.1 <i>pC</i> から 0.5 <i>pC</i> までの入力に対するプリアンプの外部出力 30 4.10 ASD Pared 20	3.15	Thin Gap Chamber $[1]$	20
3.17 エンドキャップミューオントリガー [1] 22 3.18 M1 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.19 M3 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.20 Doublet / Triplet 断面図 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 4.1 タウンゼント型電子なだれ 24 4.2 各動作モードにおける印加電圧と出力パルス波高の関係 26 4.3 n-Pentane の紫外線吸収断面積 26 4.4 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.5 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.6 Wire 方向の読み出し部分の構造 [1] 28 4.7 TGC の電場 (左)・電位 (右) 構造のシミュレーション [16] 28 4.8 ASD ASIC 回路図 29 4.9 オシロスコープで見た 0.1pC から 0.5pC までの入力に対するプリアンプの外部出力 30	3.16	ATLAS 実験のトリガーシステムのスキーム [11]	21
3.18 M1 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.19 M3 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.20 Doublet / Triplet 断面図 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 4.1 タウンゼント型電子なだれ 24 4.2 各動作モードにおける印加電圧と出力パルス波高の関係 26 4.3 n-Pentane の紫外線吸収断面積 26 4.4 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.5 TGC の構造 (平面図) 27 4.6 Wire 方向の読み出し部分の構造 [1] 28 4.7 TGC の電場 (左)・電位 (右) 構造のシミュレーション [16] 28 4.8 ASD ASIC 回路図 29 4.9 オシロスコープで見た 0.1pC から 0.5pC までの入力に対するプリアンプの外部出力 30 4.10 ACD Parend 20	3.17	エンドキャップミューオントリガー [1]	22
3.19 M3 ステーションの TGC の配置 [1] 22 3.20 Doublet / Triplet 断面図 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 4.1 タウンゼント型電子なだれ 24 4.2 各動作モードにおける印加電圧と出力パルス波高の関係 26 4.3 n-Pentane の紫外線吸収断面積 26 4.4 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.5 TGC の構造 (平面図) 27 4.6 Wire 方向の読み出し部分の構造 [1] 28 4.7 TGC の電場 (左)・電位 (右) 構造のシミュレーション [16] 28 4.8 ASD ASIC 回路図 29 4.9 オシロスコープで見た 0.1pC から 0.5pC までの入力に対するプリアンプの外部出力 30 4.10 ASD Pared 20	3.18	M1 ステーションの TGC の配置 [1]	22
3.20 Doublet / Triplet 断面図 [1] 23 3.21 トリガースキーム [11] 23 4.1 タウンゼント型電子なだれ 24 4.2 各動作モードにおける印加電圧と出力パルス波高の関係 26 4.3 n-Pentane の紫外線吸収断面積 26 4.4 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.5 TGC の構造 (平面図) 27 4.6 Wire 方向の読み出し部分の構造 [1] 28 4.7 TGC の電場 (左)・電位 (右) 構造のシミュレーション [16] 28 4.8 ASD ASIC 回路図 29 4.9 オシロスコープで見た 0.1pC から 0.5pC までの入力に対するプリアンプの外部出力 30 4.10 ASD Baard 20	3.19	M3 ステーションの TGC の配置 [1]	22
3.21 トリガースキーム [11] 23 4.1 タウンゼント型電子なだれ 24 4.2 各動作モードにおける印加電圧と出力パルス波高の関係 26 4.3 n-Pentane の紫外線吸収断面積 26 4.4 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.5 TGC の構造 (平面図) 27 4.6 Wire 方向の読み出し部分の構造 [1] 28 4.7 TGC の電場 (左)・電位 (右) 構造のシミュレーション [16] 28 4.8 ASD ASIC 回路図 29 4.9 オシロスコープで見た 0.1pC から 0.5pC までの入力に対するプリアンプの外部出力 30 4.10 ASD Pared 20	3.20	Doublet / Triplet 断面図 [1]	23
4.1 タウンゼント型電子なだれ 24 4.2 各動作モードにおける印加電圧と出力パルス波高の関係 26 4.3 n-Pentaneの紫外線吸収断面積 26 4.4 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.5 TGC の構造 (平面図) 27 4.6 Wire 方向の読み出し部分の構造 [1] 27 4.7 TGC の電場 (左)・電位 (右) 構造のシミュレーション [16] 28 4.8 ASD ASIC 回路図 29 4.9 オシロスコープで見た 0.1pC から 0.5pC までの入力に対するプリアンプの外部出力 30 4.10 ASD Paered 20	3.21	トリガースキーム [11]	23
4.1 クリンビンド型電子なたり 24 4.2 各動作モードにおける印加電圧と出力パルス波高の関係 26 4.3 n-Pentaneの紫外線吸収断面積 26 4.4 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.5 TGC の構造 (平面図) 27 4.6 Wire 方向の読み出し部分の構造 [1] 27 4.7 TGC の電場 (左)・電位 (右) 構造のシミュレーション [16] 28 4.8 ASD ASIC 回路図 29 4.9 オシロスコープで見た 0.1pC から 0.5pC までの入力に対するプリアンプの外部出力 30 4.10 ASD Beard 20	41	タウンゼント刑電子なだれ	24
4.3 n-Pentane の紫外線吸収断面積 26 4.4 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.5 TGC の構造 (平面図) 27 4.6 Wire 方向の読み出し部分の構造 [1] 27 4.7 TGC の電場 (左)・電位 (右) 構造のシミュレーション [16] 28 4.8 ASD ASIC 回路図 29 4.9 オシロスコープで見た 0.1pC から 0.5pC までの入力に対するプリアンプの外部出力 30 4.10 ASD Paered 20	4.9	冬動作モードにおける印加雪圧と出力パルス波喜の閉係	21
4.4 TGC の構造 (断面図) [1] 27 4.5 TGC の構造 (平面図) 27 4.6 Wire 方向の読み出し部分の構造 [1] 27 4.7 TGC の電場 (左)・電位 (右) 構造のシミュレーション [16] 28 4.8 ASD ASIC 回路図 29 4.9 オシロスコープで見た 0.1pC から 0.5pC までの入力に対するプリアンプの外部出力 30 4.10 ASD Beard 20	1.2 / 3		26
4.4 FGC の構造(副菌菌)[1] 27 4.5 TGC の構造(平面図) 27 4.6 Wire 方向の読み出し部分の構造[1] 28 4.7 TGC の電場(左)・電位(右)構造のシミュレーション[16] 28 4.8 ASD ASIC 回路図 29 4.9 オシロスコープで見た 0.1pC から 0.5pC までの入力に対するプリアンプの外部出力 30 4.10 ASD Beard 20	4.0	TCCの構造(断面図)[1]	20
4.6 Wire 方向の読み出し部分の構造 [1] 28 4.7 TGC の電場 (左)・電位 (右) 構造のシミュレーション [16] 28 4.8 ASD ASIC 回路図 29 4.9 オシロスコープで見た 0.1pC から 0.5pC までの入力に対するプリアンプの外部出力 30 4.10 ASD Beard 20	т.т 45	TCCの構造 (画面図) [1] ···································	21
4.6 Wile 所向の記の田 ひおりの構造[1] 26 4.7 TGC の電場 (左)・電位 (右) 構造のシミュレーション [16] 28 4.8 ASD ASIC 回路図 29 4.9 オシロスコープで見た 0.1pC から 0.5pC までの入力に対するプリアンプの外部出力 30 4.10 ASD Read	<u>т.</u> 0 4.6	Wire 方向の詩み出し部分の構造 [1]	21
4.8 ASD ASIC 回路図 29 4.9 オシロスコープで見た 0.1pC から 0.5pC までの入力に対するプリアンプの外部出力 30 4.10 ASD Beamd 20	т.0 Д 7	TCC の需提 (左)・需位 (右) 構造のシミュレーション [16]	20 28
4.9 オシロスコープで見た 0.1pC から 0.5pC までの入力に対するプリアンプの外部出力 30 4.10 ASD Brand	н. 1 Л 8		20 20
$10 \text{ ACD } \text{Drand} \qquad 20$	4.0 / 0	ADD ADD 自興会 $1nC$ から $0.5nC$ キアの λ カに対すスプリアンプの外部出力	29 20
	ч. Э 4 10		30 30

4.11	粒子の持つ運動量と dE/dx	32
5.1	FNS 島瞰図	34
5.2	T7 概略図	35
5.3	小型 TGC 概略図	35
5.4	2.5MeV TGC 設置位置	36
5.5	14MeV TGC 設置位置(加速劣化試験)	36
5.6	14MeV TGC 設置位置 (加速の) ロークスタディ)	36
5.7	ADC データ取得回路図	37
5.8	ADC 信号タイミング	37
5.9	TMC データ取得回路図	38
5.10	TMC 信号タイミング	38
5 11	モーターシステム図	30
5.12		30
5.12		40
5.14		40
5 15		41
5.10		42
5.10		40
0.17 F 10	$IGU \cup MIF による山川电何里 ····································$	43
5.18		44
5.19		44
5.20	$2.5M \text{ ev } CO_2 \text{ 55:45} 2.7kv \dots \dots$	40
5.21	$2.5M \text{ eV } CO_2 \text{ 55:45 } 3.0 \text{ eV } \dots $	45
5.22	$2.5MeV CO_2 55:45 3.3kV \dots$	45
5.23	$2.5MeV CO_2 70:30 2.7kV \dots \dots$	45
5.24	$2.5MeV CO_2 70:30 3.0kV \dots \dots$	45
5.25	$2.5MeV CO_2 70:30 3.3kV \dots \dots$	45
5.26	$2.5MeV \ CF_4 \ 55:45 \ 2.7kV \ \ldots \ $	45
5.27	$2.5MeV \ CF_4 \ 55:45 \ 3.0kV \ \ldots \ $	45
5.28	$2.5MeV CF_4 55:45 3.3kV \ldots \ldots$	45
5.29	$2.5 MeV CF_4 70:30 2.7 kV \ldots $	45
5.30	$2.5MeV \ CF_4 \ 70:30 \ 3.0kV \ \ldots \ $	45
5.31	$2.5MeV CF_4 70:30 3.3kV \ldots \ldots$	45
5.32	$14MeV CO_2 55:45 2.7kV \ldots \ldots$	46
5.33	$14MeV\ CO_2\ 55:45\ 3.0kV$	46
5.34	$14MeV\ CO_2\ 55:45\ 3.3kV$	46
5.35	$14MeV\ CO_2\ 70:30\ 2.7kV$	46
5.36	$14MeV CO_2 70:30 \ 3.0kV \qquad \dots \qquad $	46
5.37	$14MeV\ CO_2\ 70:30\ 3.3kV$	46
5.38	$14MeV CF_4 55:45 2.7kV \ldots \ldots$	46
5.39	$14MeV CF_4 55:45 3.0kV \ldots \ldots$	46
5.40	$14MeV\ CF_4\ 55:45\ 3.3kV$	46
5.41	$14MeV \ CF_4 \ 70:30 \ 2.7kV$	46
5.42	$14MeV \ CF_4 \ 70:30 \ 3.0kV$	46
5.43	$14MeV \ CF_4 \ 70:30 \ 3.3kV$	46
5.44	カレントモニターディスプレイ	47
5.45	2.5 MeV 中性子照射時の放電レート	47

5.46	14MeV中性子照射時の放電レート	47
5.47	$2.5 MeV$ の中性子、即発 γ の到達時間	48
5.48	$14 MeV$ の中性子、即発 γ の到達時間	48
5.49	クロストークのないイベント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
5.50	クロストークのあるイベント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
5.51	シミュレーションでの TGC の構造	53
5.52	中性子感度	55
5.53	TGC を構成する物質の中性子感度	55
5.54	FR4 起源の原子核の分布	56
5.55	TGCに落とされたエネルギー分布	57
5.56	Fig.5.55 の 0.5 <i>MeV</i> 以上の分布の拡大図	57

Table List

2.1	LHC 加速器主要パラメータ [8]	5
3.1	MDT の各種パラメータ [1]	17
3.2	CSC の各種パラメータ [1]	18
3.3	RPC の各種パラメータ [1]	19
3.4	TGC の 各種パラメータ [1]	20
4.1	各種ガスによる電子捕獲確率の違い....................................	26
5.1	FNS 加速器概要	33
5.2	各ビームラインでのパラメータ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
5.3	中性子感度	41
5.4	パルスモード各種パラメータ....................................	48
5.5	クロストークレート	49
5.6	シミュレーションセットアップの各種パラメータ	53

Reference

- [1] ATLAS Muon Spectrometer Technical Design Report, CERN/LHCC/97-22 ATLAS TDR (27 May 1997)
- [2] ATLAS Collaboration, Muon Spectrometer Technical Design Report, CERN/LHCC 97-22, 1997
- [3] I. Dawson, "MDT Background rate predictions using FLUKA2000"
- [4] 神戸大学 杉本拓也、修士学位論文「ATLAS 実験用大型ミューオントリガーチェンバー検査設備の構築と評価」、2003 年 2 月
- [5] H. Nanjo, et al., Nucl. Instr. and Meth. A543(2005) 441
- [6] M.Hoglmann, et al., Nucl. Instr. and Meth. A494(2002) 179
- [7] CERN Public home ,http://public.web.cern.ch/public/
- [8] LHC Large Hadron Collider Home Page ,http://lhc-new-homepage.web.cern.ch/lhc-new-homepage/
- [9] 東京大学 藤井祐介、修士が食い論文「ATLAS 前後方ミューオントリガーシステムオンライン系の開発と統 合テストビームによる動作検証」,2005 年 1 月
- [10] ATLAS DETECTOR AND PHYSICS PERFORMANCE Technical Design Report Volume II, CERN/LHCC/99-15 ATLAS TDR (25 May 1999)
- [11] ATLAS Level1 Trigger Technical Design Report, ATLAS TDR-12 (20 Aug 1998)
- [12] S.Majewski,G.Charpak,A.Breskin,and G.Mikenberg, A THIN MULTIWIRE CHAMBER OPERATING IN THE HIGH MULTIPLICATION MODE, Nucl. Instr. and Meth. ,217(1983)265-271
- [13] 高エネルギー物理学実験、パリティ物理学コース、真木晶弘、丸善(30 Sep 1997)
- [14] 粒子線検出器 放射線計測の基礎と応用 -, K. クラインクネヒト, 培風館 (15 Dec 1987)
- [15] 東京大学 深津吉聡、修士学位論文「ATLAS 実験ミューオントリガー用 Thin Gap Chamber の動作原理の 研究」,1998 年 3 月
- [16] 東京大学 長嶋壮洋、修士学位論文「ATLAS 実験ミューオントリガー用 Thin Gap Chamber の量産と動作 検証」,2000 年 2 月
- [17] 東京大学 津野総司、修士学位論文「ATLAS 実験ミューオントリガー検出器のバックグラウンド放射線に対 する動作研究」,1999 年 1 月
- [18] 東京大学 南條創、修士学位論文「アトラス実験ミューオントリガー用検出器の中性子バックグラウンドに対 する動作研究」,2001 年 1 月
- [19] JAERI-M 83-219 "Neutron Yield Monitors for The Fusion Neutronics Source (FNS) For 80 degree Beam Line"